



СОДЕРЖАНИЕ

1. Транзисторы.....	4
1.1 Транзисторы малой и большой мощности.....	4
1.2 Составные биполярные транзисторы.....	13
1.3 Полевые транзисторы.....	15
1.4 Транзисторы для поверхностного монтажа.....	16
1.5 Транзисторные матрицы.....	16
1.6 Бескорпусные транзисторы с гибкими выводами.....	17
2. Диоды.....	17
2.1 Диоды Шоттки.....	17
2.2 Выпрямительные диоды.....	18
3. Тиристоры.....	19
4. Силовые модули.....	20
4.1 Силовые модули диодные, диодно-тиристорные, тиристорные.....	20
4.2 Силовые модули на базе IGBT и FRD.....	20
5. Интегральные схемы.....	21
5.1 Интегральные схемы для поверхностного монтажа.....	21
5.2 Интегральные схемы для автомобильной электроники.....	23
5.3 Интегральные схемы линейных стабилизаторов напряжения.....	24
5.4 Интегральные схемы линейных стабилизаторов с низким проходным напряжением.....	27
5.5 Интегральные схемы управления импульсными источниками питания.....	28
5.6 Интегральные схемы управления нагрузками.....	29
5.7 Интегральные схемы, операционные усилители, компараторы, детекторы.....	30
5.8 Интегральные схемы для телефонии.....	30
5.9 Высоковольтные интегральные схемы для устройств отображения информации.....	31
5.10 Интегральные схемы для управления сетевым напряжением.....	32
5.11 ДТЛ.....	32
6. Корпуса.....	33



Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Pк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
2Т208А	BCY93	PNP	0,2	20	20	20	0,15	20-60	0,3	0,3	0,06	5	-60+125°С	ТО-18 (КТ-1)
2Т208Б				20	20			40-120						
2Т208В				20	20			80-240						
2Т208Г				30	30			20-60						
2Т208Д				30	30			40-120						
2Т208Е				30	30			80-240						
2Т208Ж				45	45			20-60						
2Т208И				45	45			40-120						
2Т208К				45	45			80-240						
2Т208Л				60	60			40-120						
2Т208М				60	60			80-240						
КТ209А		PNP	0,2	15	15	10	0,3	20-60	0,4	0,3	0,03	5	-45+100°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ209Б				15	15	10		40-120						
КТ209Б1				15	15	5		12						
КТ209В1				15	15	10		13						
КТ209В				15	15	10		80-240						
КТ209Г				30	30	10		20-60						
КТ209Д				30	30	10		40-120						
КТ209Е				30	30	10		80-240						
КТ209Ж				45	45	20		20-60						
КТ209И				45	45	20		40-120						
КТ209К				45	45	20		80-240						
КТ209Л				60	60	20		40-120						
КТ209М				60	60	20		80-240						
КТ3102АМ	BC547А	NPN	0,25	50	50	5	0,2	100-200				200	-40+85°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ3102БМ	BC547В			50	50			200-500						
КТ3102ВМ	BC548В			30	30			200-500						
КТ3102ГМ				20	20			400-500						
КТ3102ДМ	BC549С			30	30			200-500						
КТ3102ЕМ				20	20			400-1000				300		
КТ3102ЖМ				50	50			100-250				200		
КТ3102ИМ				50	50			200-500				200		
КТ3102КМ				30	30			200-500				200		
КТ3102А2		NPN	0,25	50	50	5	0,2	100-200				200	-40+85°С	
КТ3102Б2				50	50			200-500						
КТ3102В2				30	30			200-500						
КТ3102Г2				20	20			400-500						
КТ3102Д2				30	30			200-500						
КТ3102Е2				20	20			400-1000				300		
КТ3102Ж2				50	50			100-250				200		
КТ3102И2				50	50			200-500				200		
КТ3102К2				30	30			200-500				200		
КТ3107А		PNP	0,3	50	45	5	0,1	70-140	1	0,1	0,05	250	-60+125°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ3107Б	BC308А			50	45			120-220						
КТ3107В				30	25			70-140						
КТ3107Г	BC308А			30	25			120-220						
КТ3107Д	BC308В			30	25			180-460						
КТ3107Е				25	20			120-220						
КТ3107Ж	BC309В			25	20			180-460						
КТ3107И	BC307В			50	45			180-460						
КТ3107К	BC308С			30	25			380-800						
КТ3107Л	BC309С			25	20			380-800						

*Расположение выводов у КТ3102А2 - КТ3102К2 - БКЭ в отличие от КТ3102АМ - КТ3102КМ - ЭБК.

ТРАНЗИСТОРЫ

Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Pк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
КТ3117А1		NPN	0,3	60	60	4	0,4	40-200	0,6	0,5	0,05	200	-45+85°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ3117Б1				70	70			100-300						
КТ315А1		NPN	0,15	25	25	6	0,1	30-120	0,4	0,01	0,05	250	-60+100°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ315Б1				20	20		0,1	50-350	0,4					
КТ315В1				40	40		0,1	30-120	0,4					
КТ315Г1				35	35		0,1	50-350	0,4					
КТ315Д1					40		0,1	20-90	0,6					
КТ315Е1					35		0,1	50-350	0,6					
КТ315Ж1			0,1		20		0,1	30-250	0,5					
КТ315И1			0,1		60		0,05	>30	0,9					
КТ315Р1			0,15	35	35		0,1	150-350	0,4	0,02	0,002			
КТ361А2		PNP	0,15	25	25	6	0,1	20-90	0,4	0,02	0,004	250	-60+100°С	
КТ361Б2				20	20		0,1	50-350	0,4					
КТ361В2				40	40		0,1	40-100	0,4					
КТ361Г2				40	40		0,1	50-350	0,4					
КТ361Д2				40	40		0,05	20-90	1					
КТ361Е2				35	35		0,05	50-350	1					
КТ361Ж2				10	10		0,05	50-350	1					
КТ361И2				15	15		0,05	250	0,4					
КТ361К2				60	60		0,05	50-350	0,4					
КТ3157А	2SA1320 2SA821	PNP	0,2	250	250	5	0,03	>50	1	0,015	0,003	60	-45+100°С	ТО-92 (КТ-26)
2Т3152А	BCY93	PNP	0,2	50	40	20	0,15	80	0,3	0,3	0,06	50	-60+125°С	ТО-18 (КТ-1)
2Т3152Б				40	30	20		80						
2Т3152В				30	20	20		80						
2Т3152Г				50	40	5		100						
2Т3152Д				40	40	5		100						
2Т3152Е				30	30	5		100						
КТ501А	2N945	PNP	0,35	15	15	10	0,3	20-60	0,4	0,3	0,06	5	-60+125°С	ТО-18 (КТ-1)
КТ501Б	2N940			15	15	10		40-120						
КТ501В	2N1221			15	15	10		80-240						
КТ501Г	2N3677			30	30	10		20-60						
КТ501Д				30	30	10		40-120						
КТ501Е				30	30			80-240						
КТ501Ж				45	45			20-60						
КТ501И				45	45			40-120						
КТ501К				45	45			80-240						
КТ501Л				60	60			20-60						
КТ501М				60	60			40-120						
КТ502А		PNP	0,35	40	25	5	0,15	40-120	0,6	0,01	0,001	5	-40+85°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ502Б				40	25			80-240						
КТ502В				60	40			40-120						
КТ502Г				60	40			80-240						
КТ502Д				80	60			40-120						
КТ502Е				90	80			40-120						
КТ503А		NPN	0,35	40	25	5	0,15	40-120	0,6	0,01	0,001	5	-40+85°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ503Б				40	25			80-240						
КТ503В				60	40			40-120						
КТ503Г				60	40			40-120						
КТ503Д				80	80			40-120						
КТ503Е				100	80			40-120						

ТРАНЗИСТОРЫ



Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	P _к max, Вт	U _{кб} max, В	U _{кэ} max, В	U _{эб} max, В	I _к max, А	h _{21e}	U _{кэ} нас. при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	I _к , А	I _б , А			
2Т504А 2Т504Б 2Т504В	2N5663	NPN	10	400 250 300	250 150 230	6	1	15	1	0,5	0,1	20	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ504А КТ504Б КТ504В	2N3439 2N3440	NPN	10	400 200 300	250 150 230	6	1	15	1	0,5	0,1	20	-60+100°C	ТО-39 (КТ-2)
2Т505А 2Т505Б 2Т505В		PNP	5	300 250 300	250 200 200	5	1	25 25 15	1,8 1,8 1	0,5 0,5 0,001	0,1	20	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ505А КТ505Б КТ505В	BFT1913	PNP	5	300 250 250	250 250 200	5	1	25 >25 25	1,8	0,5	0,1	20	-60+100°C	Т-39 (КТ-2)
2Т506А 2Т506Б 2Т506Б1	MPT315	NPN	10	800 600 600	400 300 300	5	2	30 30 10	0,6	0,3	0,03	10	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ506А КТ506Б	BUX 54 2N3439	NPN	10	800 800	400 300	5	2	30 30	0,8	0,3	0,03	10	-45+100°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ509А		PNP	1	500	450	5	0,02	>10				10	-45+100°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ529А		PNP	0,5	80	60	4	1	>180	0,2	0,3	0,01	10	-60+85°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ530А		NPN	0,5		60	4	1	>180	0,2	0,3	0,01	10	-60+85°C	ТО-92 (КТ-26)
2Т630А 2Т630Б	2N2405	NPN	0,8	120 120	90 80	7	1	40-120 80-240	0,3	0,15	0,015	50	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ630А КТ630Б КТ630В КТ630Г КТ630Д КТ630Е	2N1711	NPN	0,8	120 120 150 100 60 60	90 80 80 60 40 40	7	1	40-120 80-240 40-120 40-120 80-240 160-480	0,3	0,15	0,015	50	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ602АМ КТ602БМ		NPN	0,85	120	70	5	0,075	20-80 50-200	3	0,055	0,005	150	-60+125°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ626А КТ626Б КТ626В КТ626Г КТ626Д		PNP	9	45* 60* 80* 20* 20*	45 60 80 20 20	5	0,5	40-250 30-100 15-45 15-80 40-250	1	0,5	0,1	75	-40+85°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ639А КТ639Б КТ639В КТ639Г КТ639Д КТ639Е КТ639Ж КТ639И		PNP	1	45* 45* 45* 60* 60* 100* 100* 30*	45 45 45 60 60 100 100 30	5	1,5	40-100 63-160 100-250 40-100 63-160 40-100 63-160 180-400	0,5	0,5	0,05	80	-60+125°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ644А КТ644Б КТ644В КТ644Г		PNP	12,5	60 60 40 40	60 60 40 40	5	0,6	40-120 100-300 40-20 100-300	0,4	0,15	0,015	200	-60+125°C	ТО-126 (КТ-27)

Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	P _к max, Вт	U _{кб} max, В	U _{кэ} max, В	U _{эб} max, В	I _к max, А	h _{21e}	U _{кэ} нас. при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	I _к , А	I _б , А			
КТ645А КТ645Б		NPN	0,5	50 40	60 40	4 5	0,3	20-200 80	0,5	0,15	0,015	250	-45+85°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ646А КТ646Б КТ646В		NPN	1	60 40 40	50 40 40	4	0,5	40-200 150 150-340	1	0,5	0,05	250	-45+85°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ653А КТ653Б		NPN	5	130 130	120 100	7	1	40-150 80-250	0,5	0,15	0,015	50	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
2Т653А 2Т653Б	2N4271	NPN	5	130 130	120 100	7	1	40-150 80-250	0,5	0,15	0,015	50	-60+125°C	ТО-39 (КТ-2)
КТ683А КТ683Б КТ683В КТ683Г КТ683Д КТ683Е		NPN	8	150 120 120 100 60 60	90 80 80 60 40 40	7	1	40-120 80-240 40-120 40-120 80-240 160-480	1	0,45	0,15	40	-60+125°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ719А	BD171	NPN	10	120	100		1,5	20	0,6	0,5	0,05	3	-60+100°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ720А	BD170	PNP	10	120	100		1,5	20	0,6	0,5	0,05	3	-60+100°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ721А	BD235	NPN	25	120	100		1,5	20	0,8	0,5	0,05	3	-60+100°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ722А	BD236	PNP	25	120	100		1,5	20	0,6	0,5	0,05	3	-60+100°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ723А	BD167	NPN	60	120	100		10	20	2	5	0,5	3	-60+100°C	ТО-220 (КТ-28)
КТ724А	BD168	PNP	60	120	100		10	20	2	5	0,5	3	-60+100°C	ТО-220 (КТ-28)
КТ729А КТ729Б		NPN	150	50 100	40 60		30 20	15-60 15-60	2 1,4	15 10	1,5 1	0,2	-60+125°C	ТО-3 (КТ-9)
КТ730А		NPN	150	160	140		16	15-60	1,4	8	1,8	0,2	-60+125°C	ТО-3 (КТ-9)
КТ805АМ КТ805БМ КТ805ВМ КТ805ИМ		NPN	30	160 135 135 135	60	5	10	15 15 15 25	5 5 5	5 5 5	0,5	20	-60+100°C	ТО-220 (КТ-28)
КТ805НМ1 КТ805НМ2		NPN	30	250	250	5	5	70-140 140-200	1,0	1,5	0,03	20	-60+100°C	ТО-220 (КТ-28)
КТ814А КТ814Б КТ814В КТ814Г		PNP	10	40 50 70 100	25 40 60 80	5	1,5	40-275 40-275 40-275 30-275	0,6	0,5	0,05	3	-40+100°C	ТО-126 (КТ-27)
КТ815А КТ815Б КТ815В КТ815Г		NPN	10	40 50 70 100	25 40 60 80	5	1,5	40-275 40-275 40-275 30-275	0,6	0,5	0,05	3	-40+100°C	ТО-126 (КТ-27)

ТРАНЗИСТОРЫ

ТРАНЗИСТОРЫ



Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Pк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
КТ816А		PNP	25	40	25	5	3	25-275	0,6	1	0,1	3	-40+100°С	ТО-126
КТ816Б	BD234			45	45									(КТ-27)
КТ816В	BD236			60	60									
КТ816Г	BD238			100	80									
КТ817А		NPN	25	40	25	5	3	25-275	0,6	1	0,1	3	-40+100°С	ТО - 126
КТ817Б	BD233			45	45									(КТ-27)
КТ817В	BD235			60	60									
КТ817Г	BD237			100	80									
КТ818А	BD202	PNP	60	40	25	5	15	15-225	2	5	0,5	3	-40+100°С	ТО-220
КТ818Б	BD302			50	40			20-225						(КТ-28)
КТ818В	BD796			70	60			15-225						
КТ818Г	BD304			90	80			12-225						
КТ818А1		PNP	100	40	25	5	15	15-275	2	5	0,5	3	-40+100°С	ТО-218
КТ818Б1				50	40			20-275						(КТ-43)
КТ818В1				70	60			15-275						
КТ818Г1				90	80			12-275						
КТ818АМ	BD22А	PNP	100	40	25	5	10	15-275	2	5	0,5	3	-40+100°С	ТО-218
КТ818БМ	BDX92			50	40			20-275						(КТ-43)
КТ818ВМ	2N5867			70	60			15-275						
КТ818ГМ	BDX18			100	80			12-275						
2Т818А	2N5880	PNP	100	100	80	5	15	20	1	5	0,5	3	-60+125°С	ТО-3
2Т818Б	BDW52			80	60									(КТ-9)
2Т818В				40	60									
2Т818А2		PNP	40	100	100	5	15	>20	1	5	0,5	3	-60+100°С	ТО-220
2Т818Б2				80	80									(КТ-28)
2Т818В2				60	60									
КТ819А	2SC1354	NPN	60	40	25	5	10	15-275	2	5	0,5	3	-40+100°С	ТО-220
КТ819Б	BD501			50	40			20-275						(КТ-28)
КТ819В	BD501			70	60			15-275						
КТ819Г	2N6110			100	80			12-275						
КТ819А1		NPN	100	40	25	5	15	15-275	2	5	0,5	3	-40+100°С	ТО-218
КТ819Б1				50	40			20-275						(КТ-43)
КТ819В1				70	60			15-275						
КТ819Г1				100	80			12-275						
КТ819АМ	BD130	NPN	100	40	25	5	15	15-275	2	5	0,5	3	-40+100°С	ТО-218
КТ819БМ	BDW21А			50	40			20-275						(КТ-43)
КТ819ВМ	BDX91			70	60			15-275						
КТ819ГМ	2N3055			100	80			12-275						
2Т819А	2N5068	NPN	100	100	80	5	15	20	1	5	0,5	3	-60+125°С	ТО-3
2Т819Б	BDW51			80	60									(КТ-9)
2Т819В				60	40									
2Т819А2		NPN	40	100	100	5	15	>20	1	5	0,5	3	-60+100°С	ТО-220
2Т819Б2				80	80									(КТ-28)
2Т819В2				60	60									
2Т830А	2N5781	PNP	5	35	25	12	2	25	0,6	1	1	4	-60+125°С	ТО-39
2Т830Б				60	45	5		25						(КТ-2)
2Т830В				80	60	5		25						
2Т830Г				100	80	5		20						

ТРАНЗИСТОРЫ

Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Pк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
КТ830А	2N5781	PNP	5	35	25	12	2	25	0,6	1	1	4	-60+100°С	ТО-39
КТ830Б				60	45	5		25						(КТ-2)
КТ830В				80	60	5		25						
КТ830Г				100	80	5		20						
2Т831А	2N4300	NPN	5	35	25	12	2	25	0,6	1	1	4	-60+125°С	ТО-39
2Т831Б				60	45	5		25						(КТ-2)
2Т831В				80	60	5		25						
2Т831Г				100	80	5		20						
КТ831А	2N4300	NPN	5	35	25	12	2	25	0,6	1	1	4	-60+100°С	ТО-39
КТ831Б				60	45	5		25						(КТ-2)
КТ831В				80	60	5		25						
КТ831Г				100	80	5		20						
2Т836А	2N3204	PNP	5	90	80	5	3	20	0,6	2	0,2	4	-60+125°С	ТО-39
2Т836Б				85	80				0,35		0,08			(КТ-2)
2Т836В				85	80				0,35		0,08			
2Т836Г				60	40				0,45		0,2			
КТ836А		PNP	5	90	80	5	3	20	0,6	2	0,2	4	-60+125°С	ТО-39
КТ836Б				85	80				0,35		0,08			(КТ-2)
КТ836Б1				85	80	13			0,35		0,08			
КТ836В				60	40				0,45		0,2			
КТ837А		PNP	30	80	70	15	7,5	10-40	2,5	3	0,37	2,5	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ837Б	2N6106			80	70	15		20-80	2,5			2,5		
КТ837В				80	70	15		50-150	2,5			2,5		
КТ837Г				60	55	15		10-40	0,9			0,9		
КТ837Д	2N6108			60	55	15		20-80	0,9			0,9		
КТ837Е				60	55	15		50-150	0,9			0,9		
КТ837Ж	2N6132			45	40	15		10-40	0,5			0,5		
КТ837И				45	40	15		20-80	0,5			0,5		
КТ837К	2N6110			45	40	15		50-150	0,5			0,5		
КТ837Л				80	73	5		10-40	2,5			2,5		
КТ837М				80	73	5		20-80	2,5			2,5		
КТ837Н				80	73	5		50-150	2,5			2,5		
КТ837П				60	55	5		10-40	0,9			0,9		
КТ837Р				60	55	5		20-80	0,9			0,9		
КТ837С				60	50	5		50-150	0,9			0,9		
КТ837Т				45	40	5		10-40	0,5			0,5		
КТ837У				45	40	5		20-80	0,5			0,5		
КТ837Ф				45	40	5		50-150	0,5			0,5		
КТ837Х				180	180	5		15	0,5			0,5		
КТ840А	2SD841	NPN	6	900	400	6	6	10-60	2	4	1,15	80	-45+100°С	ТО-3
КТ840Б	BUX97			750	350			10						(КТ-9)
КТ840В	2N5805			800	375			10-100						
2Т841А	2SC2122	NPN	50	600	350	5	10	12	1,5	5	1	7	-60+125°С	ТО-3
2Т841Б				400	250			12						(КТ-9)
2Т841В				800	400			10						
2Т841А1		NPN	30	600	600	5	10	>10	1,5	5	1	70	-60+125°С	ТО-220
2Т841Б1														(КТ-28)
КТ841А	2SC1477	NPN	50	600	350	5	10	12	1,5	5	1	10	-45+100°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ841Б	2SC1308			400	250			12	1,5			10		
КТ841В				600	350			12	1,5			10		
КТ841Г	2SC409			250	150			20	2,2			7		
КТ841Д	2SC2139			500	400			20	2,2			5		
КТ841Е				800	400			10	1,5			7		

ТРАНЗИСТОРЫ



Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Pк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
2Т842А 2Т842Б	2SB506А	PNP	50	300 200	250 150	5	5	15	1,8	5	1	20	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
2Т842А1 2Т842Б1		PNP	30	300	300	5	5	>10	1,8	5	1	10	-60+125°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ842А КТ842Б КТ842В	ВUX66А BDX30	PNP	50	300 200 200	250 150 200	5	5	15 15 20	1,8 1,8 2,2	5	1	20	-45+100°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ850А КТ850Б КТ850В	2SD401А 2N6477	NPN	25	250 300 300	200 250 250	5	2	40-200 20 20	1	0,5	0,1	20	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ851А КТ851Б КТ851В	2SB546А 2SA740 2SB628	PNP	25	250 300 180	200 250 150	5	2	40-200 20 20	1	0,5	0,1	20	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ854А КТ854Б	BU407D BU408	NPN	60	600 400	350 200	5	10	20	2	5	1	10	-40+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ855А КТ855Б КТ855В	BD942 BD956	PNP	40	250 150 150	200 150 150	5	5	20 20 15	1	2	0,4	5	-40+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ857А КТ857Б	BU408	NPN	60	250 250	250 250	6	7	7,5	1	3	0,4	9,9	-55+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ858А КТ858Б	BU104DP	NPN	60	400 400	400 400	6	7	10	1	5	0,8	9,9	-55+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ859А	2SD841	NPN	40	800	400	5	3	10	1,5	1	0,2	9,9	-55+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ863А КТ863Б КТ863В	2N6669 BD945	NPN	50	30 30 160	30 30 30	5	10	100	0,3	5	0,5	4	-40+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ864А	2SD287C	NPN	100	200	160	5	10	40-200	2	6	0,6	15	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ865А	2SA1073	PNP	100	200	160	5	10	40-200	2	6	0,6	15	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ867А	TIP35D	NPN	100	200	200	5	25	12	1,5	20	0,4	25	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
2Т875А 2Т875Б 2Т875В 2Т875Г	2N5626 2N4130 BDW21 2SC1115	NPN	50	90 70 40 80	60 60 50 90	5	10	80-250 80-250 80-250 40-160	0,5	5	1	20	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
2Т876А 2Т876Б 2Т876В 2Т876Г	MJE2955 2N5625 2N5621 MEJ2955	PNP	50	90 70 50 80	60 60 40 90	5	10	80-250 80-250 80-250 40-160	0,5	5	1	20	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
2Т880А 2Т880Б 2Т880В 2Т880Г 2Т880Д		PNP	50	100 80 50 100 80	80 60 40 80 80	5	2	80-250 80-250 80-250 40-160 40-350	0,35	1	0,2	30	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)

ТРАНЗИСТОРЫ

Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Pк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
2Т881А 2Т881Б 2Т881В 2Т881Г 2Т881Д		NPN	5	100 80 50 80 80	80 60 40 100 80	5	2	80-250 80-250 80-250 40-100 40-350	0,35	1	0,2	30	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)
2Т888А 2Т888Б		PNP	7	900 600	900 600	7	0,1	30-120	1	0,02	0,004	15	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ8101А КТ8101Б	MJE4343 BDV96 2SA1106	NPN	150	200 160	160 120	5	16	20	2	6	0,6	10	-60+125°С	ТО-218 (КТ-43)
КТ8102А КТ8102Б	MJE4353 2SD1148	PNP	150	200 160	160 120	5	16	20	2	6	0,6	10	-60+125°С	ТО-218 (КТ-43)
КТ8110А КТ8110Б КТ8110В	2SC4161	NPN	60	500 500 500	400 400 350	5	7	15-30 15 15	0,8	4	0,8	20	-45+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ8163А		NPN	50	600	500	5	7	8-40	0,5	1	0,2	30	-45+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ8167А КТ8167Б КТ8167В КТ8167Г КТ8167Д		PNP	5	100 80 60 100 80	60 60 40 80 80	5	2	80-250 80-250 80-250 40-160 160-350	0,35	1	0,2	30	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)
КТ8168А КТ8168Б КТ8168В КТ8168Г КТ8168Д		NPN	5	100 80 60 100 80	60 60 40 80 80	5	2	80-250 80-250 80-250 40-160 160-350	0,35	1	0,2	30	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)
КТ8216А КТ8216Б КТ8216В КТ8216Г	MJD31 MJD31А MJD31В MJD31С	NPN	40	40 60 80 100	40 60 80 100	5	10	15-275 20-275 15-275 12-275	1,5	6	0,6	3	-60+125°С	ТО-251
КТ8217А КТ8217Б КТ8217В КТ8217Г	MJD32 MJD32А MJD32В MJD32С	PNP	40	40 60 80 100	40 60 80 100	5	10	15-275 20-275 15-275 12-275	1,5	6	0,6	3	-60+125°С	ТО-251
КТ8254А КТ8254Б		NPN	20	800 600	800 600	7 5	2 2	>30	0,6	0,3	0,03	10	-60+100°С	ТО-251
КТ940А КТ940Б КТ940В	BF259 BF258	NPN	10	300 250 160	300 250 160	5	0,1	25	1	0,03	0,006	90	-45+85°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ961А КТ961Б КТ961В КТ961Г	BDC01D BD371C	NPN	12,5	100 80 60 40	80 60 40 35	5	1,5	40-100 63-160 100-250 200-500	0,5	0,5	0,05	50	-45+85°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ969А	BF419	NPN	6	300	250	5	0,1	50	1	0,015	0,003	90	-45+85°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ9115А КТ9115Б	2SA886 2SA794	PNP	10	300 150	300 150	5	0,1	25	1	0,03	0,006	90	-45+100°С	ТО-126 (КТ-27)

ТРАНЗИСТОРЫ



Транзисторы малой и большой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Рк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
2Т9117А	2N6553	NPN	5	100	60	5	1	80-250	0,3	0,15	0,015	50	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)
2Т9117Б				80	60									
2Т9117В				50	40									
2Т9117Г				50	40									
КТ9120А	BD706	PNP	60		45	5	12	40	0,6	8	0,4	50	-45+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ9157А	2SC2270	NPN	10	30	20	5	5	140-450	1	4	0,1	100	-45+100°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ9166А	BD743	NPN	60		45	5	15	50	0,5	8	0,4	90	-45+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ9180А	2SA1658	PNP	12,5	40	30	5	3	60-400	0,5	2	0,2	100	-45+85°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ9180Б				60	40			50	0,6					
КТ9180В				80	60			50	0,6					
КТ9180Г				100	80			50	0,6					
КТ9181А	D42C2N	NPN	12,5	40	30	5	3	60-400	0,5	2	0,2	100	-45+85°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ9181Б	MJE180			60	40			50	0,6					
КТ9181В				80	60			50	0,6					
КТ9181Г				100	80			50	0,6					
КТ9186А		NPN	5	100	60	5	1	80-250	0,3	0,15	0,015	50	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)
КТ9186Б				80	60									
КТ9186В				50	40									
КТ9186Г					40									
КТ9186Д					40									

Составные биполярные транзисторы

Обозначение	Аналог	Структура	Рк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21e	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
2Т708А	2SB678	PNP	5	100	80	5	2	500	2	2	0,01	3	-60+125°С	ТО-39 (КТ-2)
2Т708Б				80	60			750						
2Т708В	BS561			60	40			750						
КТ708А		PNP	5	100	80	5	2	500	2	2	0,01	3	-60+100°С	ТО-39 (КТ-2)
КТ708Б				80	60			750						
КТ708В				60	40			750						
2Т709А	BDX86С	PNP	5	100	80	5	10	500	2	2	0,01	3	-60+125°С	ТО-66 (КТ-8)
2Т709Б	BDX86В			80	60			750						
2Т709В				60	40			750						
2Т709А2		PNP	30	100	100	5	10	>500	2	2	0,02	3	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
2Т709Б2				80	80			>750						
2Т709В2				60	60			>750						
КТ709А	MJH11019	PNP	30	100	80	5	10	500	2	2	0,01	3	-60+125°С	ТО-66 (КТ-8)
КТ709Б	MJH11017			80	60			750						
КТ709В				60	40			750						
КТ712А		PNP	50	200	160	5	10	500	2	2	0,01	3	-45+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ712Б				180	150									
КТ716А		NPN	30	100	100	5	10	750	2	5	0,02	3	-60+125°С	ТО-66 (КТ-8)
КТ716Б				80	80									
КТ716В				60	60									
2Т716А	2SD472H	NPN	30	100	80	5	10	750	2	5	0,02	3	-60+125°С	ТО-66 (КТ-8)
2Т716Б	SDN601			80	60									
2Т716В	2SD523			60	40									
2Т716А1		NPN	30	100	100	5	10	>500	2	5	0,02	3	-60+125°С	ТО-220 (КТ-28)
2Т716Б1				80	80			>750						
2Т716В1				60	60			>750						
2Т825А	2N6287	PNP	125	100	80	5	20	500-18000	2	10	0,04	3	-40+100°С	ТО-3 (КТ-9)
2Т825Б	2N6286			80	60			750-18000						
2Т825В	2N6285			60	45			750-18000						
2Т825А2		PNP	30	100	100	5	15	500-18000	2	10	0,04	3	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
2Т825Б2				80	80			750-18000						
2Т825В2				60	60			750-18000						
КТ825Г	BDX88	PNP	125	90	70	5	5	750-18000	2	5	0,02	3	-40+100°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ825Д	BDX88А			60	45			750-18000						
КТ825Е	BDX64			30	25			750-18000						
КТ827А	2SD1672	NPN	125	100	100	5	20	750-18000	2	10	0,04	4	-60+100°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ827Б	MJ3521			80	80									
КТ827В	2N6057			60	60									
КТ829А	BD267В	NPN	60	100	100	5	8	750	2	3	0,012	4	-40+85°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ829Б	BD267А			80	80			750	2	3	0,012			
КТ829В				60	60			750	2	3	0,012			
КТ829Г	BD665			45	45			750	2	3	0,012			
КТ829АТ				100	100			1000	1,1	5	0,012			
КТ829АП			50	160	150		5	700	1,25	5	0,008			
КТ829АН			60	240	240		8	400-3000	2	3	0,03			
КТ852А	2SB1286	PNP	50	100	100	5	2,5	500	2,5	2	0,08	7	-60+125°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ852Б	2SB750А			80	80									
КТ852В	2SB973А			60	60									
КТ852Г				45	45									

ТРАНЗИСТОРЫ

ТРАНЗИСТОРЫ



Составные биполярные транзисторы

Обозначение	Аналог	Структура	P _{к max} , Вт	U _{кб max} , В	U _{кэ max} , В	U _{эб max} , В	I _{к max} , А	h _{21e}	U _{кэ} нас. при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	I _к , А	I _б , А			
КТ853А	BDX54С	PNP	60	100	100	5	8	750	2	3	0,012	7	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ853Б	BD650			80	80									
КТ853В				60	60									
КТ853Г				45	45									
КТ8106А	МЖ6286	NPN	100	90	80	5	20	750-18000	2	5	0,02	4	-60+100°С	ТО-218 (КТ-43)
КТ8106Б	BDW84			60	45									
КТ8109А	TIP151	NPN	80	350	350	5	5	180	2	2,5	0,04	9,9	-45+100°С	ТО-220
2Т877А	2N6286	NPN	50	80	80	5	10	750-10000	2	10	0,04	100	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
2Т877Б	2N6285			60	60			2500-18000						
2Т877В				40	40			2500-18000						
2Т877Г				60	60		20	500-20000	1,5	1				
КТ8130А	BD876	PNP	20	40	40	5	4	750-15000	2	2	0,008	25	-45+100°С	ТО-126 (КТ-27)
КТ8130Б				60	60			750-15000	2	2	0,008			
КТ8130В				80	80			750-15000	2	2	0,008			
									3	4	0,04			
КТ8131А	BD875	NPN	20	40	40	5	4	500-15000	2	2	0,008	25	-45+85°С	ТО-126 (КТ-27)
								750-15000	3	4	0,04			
								100-15000						
КТ8131Б				60	60			500-15000	2	2	0,008			
								750-15000	3	4	0,04			
								100-15000						
КТ8131В				80	80			500-15000	2	2	0,008			
								750-15000	3	4	0,04			
								100-15000						
КТ8133А		NPN	60	240	240	5	8	300-3000	1,8	3	0,03	30	-60+125°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ8133Б				160	160									
КТ8141А		NPN	60	100	100	5	8	750	2	3	0,012	7	-60+100°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ8141Б				80	80									
КТ8141В				80	60									
КТ8141Г				45	45									
КТ896А	BDW84В	PNP	125	90	80	5	20	750-18000	2	5	0,02	4	-45+100°С	ТО-218 (КТ-43)
КТ896Б				60	45									
КТ897А	BU931Z	NPN	150	350	350	5	20	400	1,6	7	0,07	10	-60+125°С	ТО-3 (КТ-9)
	BU941Z								1,8	8	0,1			
									1,8	10	0,25			
КТ897Б				200	200				1,6	7	0,07			
									1,8	8	0,1			
									1,8	10	0,25			
КТ898А	BU931ZP	NPN	125	350	350	5	20	400	1,6	7	0,07	10	-60+125°С	ТО-218 (КТ-43)
									1,8	8	0,1			
									1,8	10	0,25			
КТ898Б				200	200				1,6	7	0,07			
									1,8	8	0,1			
									1,8	10	0,25			

ТРАНЗИСТОРЫ

Составные биполярные транзисторы

Обозначение	Аналог	Структура	P _{к max} , Вт	U _{кб max} , В	U _{кэ max} , В	U _{эб max} , В	I _{к max} , А	h _{21e}	U _{кэ} нас. при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	I _к , А	I _б , А			
КТ898А1	BU931ZPF	NPN	60	350	350	5	20	400	1,6	7	0,07	10	-60+125°С	Isowatt-218 (КТ-43А-1)
КТ898Б1				200	200				1,8	8	0,1			
									1,8	10	0,25			
КТ8171А		NPN	100	350	350	5	20	10000	2,3	8	0,01	10	-60+125°С	ТО-218 (КТ-43)
КТ8171Б				200	200									
КТ8196А		NPN	100		350	5	10	400	1,8	6	0,06	30	-60+125°С	ТО-220 (КТ-28)
КТ8196Б					300									
КТ8196В					250									
КТ8218А		NPN	30	40	40	5	4	750	2	2	0,008	25	-60+125°С	ТО-251
КТ8218Б				60	60									
КТ8218В				80	80									
КТ8218Г				100	100									
КТ8219А		PNP	30	40	40	5	4	750	2	2	0,008	25	-60+125°С	ТО-251
КТ8219Б				60	60									
КТ8219В				80	80									
КТ8219Г				100	100									
КТ8231А	BU941Z	NPN	180		350-500	5	15	300	1,8	10	0,025	10	-40+125°С	ТО-3 (КТ-9)
КТ8231А1	BU941ZP	NPN	155		350-500	5	15	300	1,8	10	0,025	10	-40+125°С	ТО-218 (КТ-43)
КТ8231А2	BU941ZPF	NPN	65		350-500	5	15	300	1,8	10	0,025	10	-40+125°С	Isowatt-218 (КТ-43А-1)
КТД8275А		NPN	125	100	100	5	20	750-18000	2	10	0,04	15	-60+100°С	ТО-3 (КТ-9)
КТД8275Б				80	80									
КТД8275В				60	60									
КТД8276А		NPN	60	100	100	5	8	>750	2	3	0,012	15	-60+85°С	ТО-218 (КТ-43)
КТД8276Б				80	80									
КТД8276В				60	60									
КТД8276Г				45	45									

ТРАНЗИСТОРЫ

Полевые транзисторы

Обозначение	Аналог	P _{max} , Вт	U _{си max} , В	U _{зи max} , В	I _{стах} , А	U _{зи пор.} , В	R _{си} , Ом	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
КП922А		60	100	±30	10	2-5	0,25	-45+85°С	ТО-3 (КТ-9)
КП922Б					5		0,5		-45+85°С
КП922А1		60	100	±30	10	2-5	0,25	-45+85°С	ТО-220 (КТ-28)
КП922Б1							0,5		-45+85°С



Транзисторы для поверхностного монтажа

Биполярные транзисторы в корпусе SOT-89 (КТ-47)

Обозначение	Аналог	Структура	Максимально допустимые значения параметров				Электрические характеристики при T = 25 °C								Диапазон рабочих температур
			I _к max, А	U _{кэо} гр, В	U _{кб} max, В	P _к max, Вт	h21э при		U _{кэ} нас при		f гр, МГц				
							min	max	I _к , А	U _{кэ} , В		I _к , А	I _б , А		
КТ664А9	BCX53	PNP	1	80	120	1	40	250	0,15	2	0,35	0,15	0,015	50	-60+100°C
КТ664Б9	BCX52	PNP	1	60	100	1	40	250	0,15	2	0,35	0,15	0,015	50	-60+100°C
2Т664А9	BCX53	PNP	1	80	120	1	40	250	0,15	2	0,3	0,15	0,015	50	-60+100°C
2Т664Б9	BCX52	PNP	1	60	100	1	40	250	0,15	2	0,3	0,15	0,015	50	-60+100°C
КТ665А9	BCX56	NPN	1	80	120	1	40	250	0,15	2	0,35	0,15	0,015	50	-60+100°C
КТ665Б9	BCX55	NPN	1	60	100	1	40	250	0,15	2	0,35	0,15	0,015	50	-60+100°C
2Т665А9	BCX56	NPN	1	80	120	1	40	250	0,15	2	0,3	0,15	0,015	50	-60+100°C
2Т665Б9	BCX55	NPN	1	60	100	1	40	250	0,15	2	0,3	0,15	0,015	50	-60+100°C
КТ666А9	BF621	NPN	0,2	250	300	1	50	-	0,005	10	0,8	0,01	0,002	60	-60+100°C
КТ667А9	-	PNP	0,2	250	300	1	50	-	0,005	10	0,8	0,01	0,002	40	-60+100°C
КТ914А9	-	PNP	0,05	300	500	1	20	150	0,01	10	0,6	0,01	0,001	30	-60+125°C
КТ914Б9	-	NPN	0,05	300	500	1	20	150	0,01	10	1,0	0,01	0,001	50	-60+125°C

Мощные биполярные транзисторы в корпусе TO-252

Обозначение	Аналог	Структура	Максимально допустимые значения параметров				Электрические характеристики при T = 25 °C								Диапазон рабочих температур
			I _к max, А	U _{кэо} гр, В	U _{кб} max, В	P _к max, Вт	h21э при		U _{кэ} нас при		f гр, МГц				
							min	max	I _к , А	U _{кэ} , В		I _к , А	I _б , А		
КТ8216А1-Г1	MJD31С	NPN	10	40-100	40-100	40	15	275	3	4	1,5	6	0,6	3	-60+100°C
КТ8217А1-Г1	MJD32С	PNP	10	40-100	40-100	40	15	275	3	4	1,5	6	0,6	3	-60+100°C
КТ8218А1-Г1	MJD112	NPN	4	40-100	40-100	30	500	-	0,5	3	2	2	0,008	25	-60+100°C
КТ8219А1-Г1	MJD117	PNP	4	40-100	40-100	30	750	-	2	3	3	4	0,04	25	-60+100°C
КТ8254А1	КТ506А	NPN	2	400	800	35	30	-	0,3	5	0,6	0,3	0,03	10	-60+100°C
КТ8254Б1	КТ506А	NPN	2	300	600	30	30	-	0,3						-60+100°C
КТ829А2		NPN	10	120	120	20	700	8000	8,4	3	1,3	5	0,012	4	-60+100°C
КТ853А2		PNP	8	100	100	20	750		3	3	1,3	5	0,012	7	-60+100°C

Транзисторные матрицы

Обозначение	Аналог	Структура	P _к max, Вт	U _{кб} max, В	U _{кэ} max, В	U _{эб} max, В	I _к max, А	h21е	U _{кэ} нас. при			f гр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	I _к , А	I _б , А			
КТ693АС		NPN	0,75	150	100		0,15	40	0,6	0,15	0,015		-60+125°C	DIP-14 (2104.14-1)
2Т693АС		NPN	0,75	150	100		0,15	40	0,6	0,15	0,015		-60+125°C	401.14-5М
КР198НТ11		NPN		70	40		0,03	40-150	0,7	0,003	0,0005		-10+85°C	DIP-14 (2104.14-1)

Бескорпусные транзисторы с гибкими выводами

Обозначение	Структура	U _{кэо} , В	U _{кэб} , В	I _к , А	h21э при			U _{кэнас} , при			Диапазон рабочих температур	Конструктивное исполнение
					min	I _к , А	U _к , В	В	I _к , А	I _б , А		
КТ820А-1	PNP	40	40	0,5	40	0,15	2	0,2	0,5	0,05	-45+85°C	
КТ820Б-1		60	60	0,5	40	0,15	2	0,2	0,5	0,05		
КТ820В-1		80	80	0,5	40	0,15	2	0,2	0,5	0,05		
КТ821А-1	NPN	40	40	0,5	40	0,15	2	0,2	0,5	0,05	-45+85°C	
КТ821Б-1		60	60	0,5	40	0,15	2	0,2	0,5	0,05		
КТ821В-1		80	80	0,5	40	0,15	2	0,2	0,5	0,05		
КТ822А-1	PNP	45	45	2	25	1	2	0,6	1	0,1	-45+85°C	
КТ822Б-1		60	60	2	25	1	2	0,6	1	0,1		
КТ822В-1		80	80	2	25	1	2	0,6	1	0,1		
КТ823А-1	NPN	45	45	2	25	1	2	0,6	1	0,1	-45+85°C	
КТ823Б-1		60	60	2	25	1	2	0,6	1	0,1		
КТ823В-1		80	80	2	25	1	2	0,6	1	0,1		
2Т830В-1	PNP	60	60	2	25	1	2	0,6	1	0,1	-60+100°C	
2Т830Г-1		80	80	2	25	1	2	0,6	1	0,1		
2Т831В-1	NPN	60	60	2	25	1	2	0,6	1	0,1	-60+100°C	
2Т831Г-1		80	80	2	25	1	2	0,6	1	0,1		

Примечание: коллектор - основание кристалла

Сборки диодов Шоттки

Обозначение	Максимально допустимое значение параметров при T=25 °C	Электрические характеристики при T = 25 °C			t восстановления, мкс не более	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса	Примечание
		I max, А	I max, импульсное, А	U обр. max, В				
КД636АС				60		TO-220	Пара диодов Шоттки с общим катодом	
КД636БС				120				
КД636ВС	2x15	2x30	200	1,2 В	80			-45+125°C
КД636ГС			400	при I=15А		TO-263		
КД636ДС			600					
КД636ЕС			800					
КД637АС			60			TO-218		Пара диодов Шоттки с общим катодом
КД637БС			120					
КД637ВС	2x25	2x50	200	1,4В	100			
КД637ГС			400	при I=15А		TO-263		
КД637ДС			600					
КД637ЕС			800					
КД638АОС			30			TO-220	Пара диодов Шоттки с общим катодом	
КД638АС			40					
КД638БС	2x5	2x8	60	1,0В	60			
КД638ВС			90	при I=5А		TO-263		
КД638ГС			120					
КД638ДС			160					
КД638ЕС			200					



Выпрямительные диоды

Обозначение	Uобр,и, V _{RRM} ' В	Iпр,ср, I _{FM} ' А	при	Iпр,уд, I _{TSM} ' А	Uпр,и, V _{FM} ' В	при	R _{th(j-c)} R _{jc} ' °С/Вт	Тип корпуса
			Ткорп, °С			Iпр,и, I _{FM} ' А		
КД2961А	400	10	105	170	1,1	10	2,5	ТО-220
КД2961Б	800							
КД2961В	1200							
КД2961Г	1600							
КД2960А	400	20	105	250	1,1	20	1,3	ТО-220
КД2960Б	800							
КД2960В	1200							
КД2961А1	400	10	105	170	1,1	10	2,5	ТО-263
КД2961Б1	800							
КД2961В1	1200							
КД2961Г1	1600							
КД2960А1	400	20	105	250	1,1	20	1,3	ТО-263
КД2960Б1	800							
КД2960В1	1200							
КД2959А	400	30	105	300	1,15	30	1,0	ТО-218
КД2959Б	800							
КД2959В	1200							
КД2958А	400	40	105	400	1,1	40	0,6	ТО-218
КД2958Б	800							
КД2958В	1200							
КД2957А	400	60	105	700	1,1	60	0,45	ТО-218
КД2957Б	800							2 выв.
КД2957В	1200							

ДИОДЫ

Тиристоры

Обозначение	Uзс, Uобр, U _{DRM} , U _{RRM} , В	Iзс, Iобр, I _{DRM} , I _{RRM} , МА	Iос гр/Т к I _{TAV} /Tс, А/°С	Iос, удр, I _{TSM} , А	Iy, от I _{GT} , МА	Uy, от U _{GT} , В	Iуд, I _P , МА	Uос, п/ Iос, U _{TM} /I _{TAV} , В/А	du/dt, В/мкс	di/dt, А/мкс	Uпор. U _T , В	Гдин, г _L , МОм	R _{th(j-c)} , R _{jc} , °С/Вт	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
КУ712А	600	0,1	8/95	120	15	1	85	1,2/8	200	150	1,011	2724	3,3	-45+100°С	ТО-251
КУ712Б	800														
КУ712В	1000														
КУ712А1	600	0,1	8/95	120	15	1	85	1,2/8	200	150	1,011	2724	3,3	-45+100°С	ТО-252
КУ712Б1	800														
КУ712В1	1000														
КУ712А2	600	0,1	6,5/112	140	15	1	30	1,15/6,5	150	100	0,85	17,3	1,5	-45+100°С	ТО-220
КУ712Б2	800														
КУ712В2	1000														
КУ709А	600	0,1	10/95	200	60	2	100	1,4/10	500	150	1,1	24,0	1,3	-45+100°С	ТО-220
КУ709Б	800														
КУ709В	1000														
КУ709Г	1200														
КУ709А2	600	0,2	16/90	300	45	2	100	1,25/16	500	150	1,0	12,0	1,1	-45+100°С	ТО-220
КУ709Б2	800														
КУ709В2	1000														
КУ709Г2	1200														
КУ710А	800	0,3	35/75	500	80	2,5	100	1,45/40	500	100	1,02	10,0	0,6	-45+100°С	ТО-218
КУ710Б	1000														
КУ710В	1200														
КУ713А	800	0,3	16/95	300	45	2,0	100	1,25/16	500	100	1,0	12,0	5,0	-45+100°С	Isowatt-218
КУ713Б	1000														
КУ713В	1200														
КУ714А	800	0,3	35/75	500	80	2,5	100	1,45/40	500	100	1,02	10,0	5,0	-45+100°С	Isowatt-218
КУ714Б	1000														
КУ714В	1200														

ТИРИСТОРЫ



Силовые модули тиристорные, диодные, диодно-тиристорные и мосты

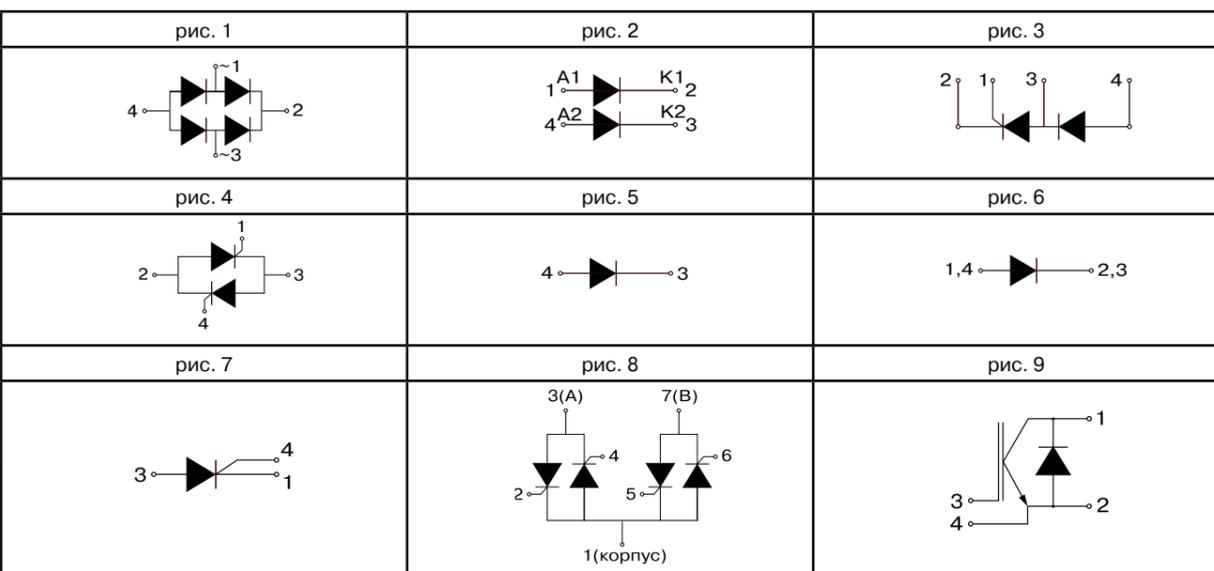
Обозначение	U_{DRM}, U_{RRM}, V	I_{DRM}, I_{RRM}, mA	$I_{T(AV)}, I_{F(AV)}, A$	$T_C, ^\circ C$	I_{TSM}, I_{FSM}, A	I_{GT}, mA	U_{GT}, V	U_{TM}, U_{FM}, V	I_{TM}, I_{FM}, A	I_L, mA	I_H, mA	$(di/dt)_{crit}, A/\mu s$	$(dU/dt)_{crit}, V/\mu s$	$R_{thjc}, ^\circ C/W$	$T_{jm, max}, ^\circ C$	Схема вкл.	Корпус
МД-4x25	400-1000	0,1	4x25	85	300	-	-	1,2	25	-	-	-	-	0,42	150	рис.1	Sot-227
МДД-2x40	400-1000	0,1	2x40	85	350	-	-	1,25	40	-	-	-	-	0,7	150	рис.2	Sot-227
МДД-2x63	400-1000	0,1	2x63	85	500	-	-	1,2	63	-	-	-	-	0,7	150	рис.2	Sot-227
МД-100	800-1200	0,3	100	70	1600	-	-	1,35	300	-	-	-	-	0,35	150	рис.5	Sot-227
МД-120	400-800	0,3	120	70	1600	-	-	1,85	360	-	-	-	-	0,35	150	рис.6	Sot-227
МДДБ-2x40*	400-800	0,1	2x40	85	350	-	-	3,0	40	-	-	-	-	0,7	150	рис.2	Sot-227
МДДБ-2x63*	600-1200	0,1	2x63	85	500	-	-	2,3	60	-	-	-	-	0,4	150	рис.2	Sot-227
МТД-40	400-1000	0,1	40	85	500	200	2,0	1,7	80	450	200	200	500	0,6	150	рис.3	Sot-227
МТТ-40	800-1200	0,1	40	85	600	200	2,0	1,7	80	250	100	200	500	0,4	150	рис.4	Sot-227
МТ-100 (КУ711)	800-1200	0,3	100	70	1500	200	2,0	1,55	300	200	100	150	500	0,35	150	рис.7	Sot-227
МПТ16-80-8	800	0,1	80	85	1500	200	2,5	1,8	250	250	250	150	500	0,4	150	рис.8	чертеж 1

*Быстровосстанавливающиеся диоды с $t_{RR} \leq 200, ns$

Силовые модули на базе IGBT и FRD

Обозначение	$U_{ка, max}, A$	$U_{изол}, B$	$I_{к, max}, A$	$I_{ка, упр}, mA (U_{ка} = 1200B, U_{изол} = 0)$	$I_{за, упр}, mA (U_{изол} = \pm 20B, U_{ка} = 0)$	$U_{за, пор}, B$	$U_{ка, нас}, B$	$U_{пр}, B$	Диапазон рабочих температур	Схема вкл.	Корпус
2М435А	1200	2500	200	4	± 500	2,5-6,5	<3	<2,8	-60+125°C	рис.9	чертеж 2
2М435Б	1200	2500	300	6	± 500	2,5-6,5	<3	<2,8	-60+125°C	рис.9	чертеж 2
2М435В	1200	2500	400	8	± 500	2,5-6,5	<3	<2,8	-60+125°C	рис.9	чертеж 2
КМ435А	1200	2500	200	4	± 500	2,5-6,5	<3	<2,8	-45+125°C	рис.9	чертеж 2
КМ435Б	1200	2500	300	6	± 500	2,5-6,5	<3	<2,8	-45+125°C	рис.9	чертеж 2
КМ435В	1200	2500	400	8	± 500	2,5-6,5	<3	<2,8	-45+125°C	рис.9	чертеж 2

Схемы включения



Интегральные схемы для поверхностного монтажа

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
КФ142ЕНХХ	78DXX	ЛСН с фиксированным напряжением 5,6,9,12,15,18,24,27В положительной полярности, I _{вых} = 1А.	-45+85°C	ТО-263, ТО-252
КФ1162ЕНХХ	79DXX	ЛСН с фиксированным напряжением 5,6,9,12,15,18,24,27В отрицательной полярности, I _{вых} = 1А.	-45+85°C	ТО-263, ТО-252
КФ1158ЕНХХА,Б	LM2931А	ЛСН с низким U _{прох} = 0,4В, U _{вх} = 26В, U _{вых} = 0,15А. Ряд фиксированных положительных напряжений в диапазоне 3 - 15В.	-45+85°C	ТО-252
КФ1158ЕНХХВ,Г	LM2931А	ЛСН с низким U _{прох} = 0,6В, U _{вх} = 60В, I _{вых} = 0,5А. Ряд фиксированных положительных напряжений в диапазоне 3 - 15В.	-45+85°C	ТО-263
КФ142ЕН12	LM317	ЛСН с регулируемым положительным U _{вых} = 1,2 - 37В, I _{вых} = 1,5А.	-10+70°C	ТО-263
КФ142ЕН18	LM337	ЛСН с регулируемым отрицательным U _{вых} = 1,2 - 37В, I _{вых} = 1,5А.	-10+70°C	ТО-263
К1156ЕН6ТХ	CS5201-3	Трехвыводной положительного напряжения ЛСН с низким U _{прох} = 1В при I _н = 1А, U _{вх} = 7В, U _{вых} = 3,3В.	-10+70°C	ТО-263
К1156ЕР1Т	TL432	Регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор с гарантируемой стабильностью U _{ref} = 1,24В ± 1%, втекающий ток 200 мА, низкий динамический импеданс 0,2 Ом, ток регулирования 150 мкА, U _{вых} = 1,24 ÷ 20В с помощью 2-х внешних резисторов.	-10+70°C	SOT-89 (КТ-47)
К1156ЕР2Т	CS5201-1	Регулируемый ЛСН положительного напряжения с U _{прох} = 1В при I _н = 1А, U _{вх} = 7В, U _{вых} = 1,25 ÷ 5,5В.	-10+70°C	ТО-263
К1156ЕУ5Т	MC34063AD	DC - DC конвертер, U _s = 3-40В, I _s = 1,5А, f _s = 0 - 100 кГц.	-10+70°C	SO-8
К1224ПН4Т	SP4422А	DC - AC преобразователь низкого входного напряжения питания (2-5В) в высокое (до 200В) для подсветки ЖКИ.	-10+70°C	SO-8
К1224ПН5Т	SP4425	DC - AC преобразователь низкого входного напряжения питания (2-5В) в высокое (до 200В) для подсветки ЖКИ.	-10+70°C	SO-8
К1033ЕУ15АТ К1033ЕУ15БТ	UC3842 UC3843	ИС управления одноктактными ИСН. Токвый /ШИМ - режим / минимальное число внешних элементов, полумостовой выход U _{s max} = 30В, I _s = 1А, f _{s max} = 500 кГц, макс. коэффициент заполнения = 100%. Схема защиты от снижения напряжения. U _{вкл} = 16В, U _{выкл} = 10В для АТ. U _{вкл} = 8,5В, U _{выкл} = 7,9В для БТ.	-10+70°C	SO-8
К1033ЕУ16АТ К1033ЕУ16БТ	UC3844 UC3845	ИС управления одноктактными ИСН. Токвый /ШИМ - режим / минимальное число внешних элементов, полумостовой выход U _{s max} = 30В, I _s = 1А, f _{s max} = 500 кГц, макс. коэффициент заполнения = 50%. Схема защиты от снижения напряжения. U _{вкл} = 16В, U _{выкл} = 10В для АТ. U _{вкл} = 8,5В, U _{выкл} = 7,9В для БТ.	-10+70°C	SO-8
К1224ПН1Т	SP4424	DC - AC конвертер - преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное напряжение для зажигания твердотельных электролюминесцентных источников света, U _{пит} = 2,2 ÷ 5В, U _{вых} > 120В, Снагр = 55нФ.	-10+70°C	SO-8



Интегральные схемы для поверхностного монтажа

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
K1224ПНЗТ	SP4412	DC – AC конвертер – преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное напряжение для подсветки ЖКИ. Упит = 2,2 ÷ 3,6В, Uвых > 120В, Снагр = 2нФ.	-10+70°C	SO – 8
K1233КТ2Т	DS1990A	М/сх электронного кодового ключа для применения в системах контроля и управления доступом контактного типа. Возможно использование: изготовление пластиковых карт, брелков, браслетов, электронных ключей с индивидуальным номером. Не требует встроенных элементов питания.	-45+85°C	SOT – 89 (КТ-47)
K1230ДПХХТ	МС34064	Детектор понижения напряжения ниже допустимого уровня, м/с предназначена для использования в микропроцессорных системах для формирования сигнала Reset во всех случаях, когда напряжение питания снижается до опасного уровня.	-45+85°C	SOT – 89 (КТ-47)
K1230ДПХХ1Т		Отличается от K1230ДПХХ - открытый коллектор выходного транзистора.	-45+85°C	SOT – 89 (КТ-47)
K1464СА1Т	LM393	ИС сдвоенного микромощного компаратора напряжения с выходом типа "открытый коллектор". Однополярное питание 2 ÷ 36В, двухполярное питание ± 1,0 ÷ ± 18В. Выходное напряжение согласуется со всеми типами логических схем.	-40+85°C	SO – 8
K1464УД1Т	LM358	ИС сдвоенного микромощного ОУ. Однополярное питание 2 ÷ 32В, двухполярное питание ± 1,5 ÷ 16В. Выходное напряжение согласуется со всеми типами логических схем.	-40+85°C	SO – 8
K1407УД2Т		Программируемый маломощный ОУ. Упит = ± 12В, Ку > 50000, Uсм < 5мВ, Iвх < 150 нА, Iпот < 100 мкА.	-45+85°C	SO – 8
1230ДП46У	МС34064	Детектор уровня напряжения для формирования сигнала в микропроцессорных системах при снижении напряжения питания до опасного уровня, с точки зрения бесспорной системы. Изготавливается в металлокерамическом герметичном корпусе.	-60+125°C	5114Ю.4-2

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Интегральные схемы для автомобильной электроники

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
K1055ХП2Р K1055ХП2Т	L497 L497D	Контроллер электронного коммутатора для бесконтактных систем зажигания с датчиком Холла.	-45+125°C	DIP – 16 SO – 16J
K1055ЕП2	без аналога	Трехканальный ЛСН, с низким проходным напряжением. Uвых = 5 – 20В, Iн = 1А, 100мА, 75мА.	-40+85°C	Мультиватт-15
K1055ЕП4	без аналога	Четырехканальный ЛСН, с низким проходным напряжением. Uвых / Iн = 12В/ 500мА, 6В/50мА, 1,2В/50мА.	-40+85°C	Мультиватт-15
K1156ЕН1	LM2925	ЛСН с низким проходным напряжением. Внешнее управление, защита от переплюсовки, выбросов по Uвх до 60В, от КЗ, тепловая защита. Uвх max = 40В, Uвых = 5В, Iн = 0,75А, Uпрох = 0,6В.	-45+85°C	ТО -220-5
K1156ЕН5В	LM2931Т	Регулируемый ЛСН с низким Uпрох. Внешнее управление, защита от переплюсовки, выбросов по Uвх до 60В, от КЗ, тепловая защита. Uвх max = 40В, Uвых = 1,5 – 35В, Iн = 0,75А, Uпрох = 0,6В.	-45+85°C	ТО -220-5
K1230ДПХХП	МС34064	Детектор понижения напряжения ниже допустимого уровня. ИС предназначена для использования в микропроцессорных системах для формирования сигнала Reset.	-45+85°C	ТО – 92 (КТ-26)
K1230ДПХХ1П		Детектор понижения напряжения ниже допустимого уровня. Отличие от микросхемы K1230ДПХХП - открытый коллектор выходного транзистора.	-45+85°C	ТО – 92 (КТ-26)
K1460УД2Р K1460УД2Р1	ТСА0372	Сдвоенный мощный операционный усилитель. Выходной ток 1,0 А, скорость нарастания 1,3В/ мкс.	-40+70С -45+125°C	DIP-8 Power DIP- (12+4)
K1464СА1Р	LM393	ИС сдвоенного микромощного компаратора напряжения.	-40+85°C	DIP-8
K1464УД1Р	LM358	Микросхема сдвоенного микромощного операционного усилителя. Напряжение питания: однополярное - 3 ÷ 32В, двухполярное ± 1,5 ÷ ± 16В. Выходное напряжение согласуется со всеми типами логических схем.	-40+85°C	DIP-8
K1055ГП1Р	МС33193	ИС управления реле ламп указателя поворотов. Упит = 8 ÷ 18В, Iвых = 1,5А, напряжения срабатывания датчика неисправности ламп 80 ÷ 95мВ.	-40+100°C	DIP-8
K1055ГП4Р	МС33193	ИС управления реле ламп указателя поворотов. Упит = 8 ÷ 18В, Iвых = 1,5А, напряжения срабатывания датчика неисправности ламп 43,6 ÷ 57мВ.	-45+100°C	DIP-8
K1055ГП6Р	без аналога	ИС управления реле ламп указателя поворотов. Упит = 19 ÷ 29В, Iвых = 1,5А.	-40+100°C	DIP-8
K1055КТ1АПКБ	без аналога	ИС токового ключа с пороговым управлением	-60+85°C	ТО – 92 (КТ-26) SOT-89

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ



Интегральные схемы линейных стабилизаторов напряжения

Обозначение	Аналог	Полярность	Выходное напряжение, (В)	Выходной ток, (А)	Входное напряжение, (В)	Нестабильн. по току, (%/А)	Нестабильн. по напряжению, (%/В)	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
142ЕН1А		P	3-12	0,15	20	11,1	0,3	-60+125°C	4112.16-15.01
142ЕН1Б			3-12	0,15	20	4,4	0,1		
142ЕН2А			12-30	0,15	40	11,1	0,3		
142ЕН2Б			12-30	0,15	40	4,4	0,1		
K142ЕН1А		P	3-12	0,15	20	11,1	0,3	-45+85°C	4112.16-15.01
K142ЕН1Б			3-12	0,15	20	4,4	0,1		
K142ЕН2А			12-30	0,15	40	11,1	0,3		
K142ЕН2Б			12-30	0,15	40	4,4	0,1		
KP142ЕН1А		P	3-12	0,15	20	11,4	0,3	-10+70°C	DIP-14 201.14-1
KP142ЕН1Б						4,4	0,1		
KP142ЕН1В						22,2	0,5		
KP142ЕН1Г						4,4	0,2		
KP142ЕН2А		P	12-30	0,15	40	11,1	0,3	-10+70°C	DIP-14 201.14-1
KP142ЕН2Б						4,4	0,1		
KP142ЕН2В						22,2	0,5		
KP142ЕН2Г						4,4	0,2		
KP142ЕН12	LM317	P	1,2-37	1,5	Vi-Vo=40	1,5	0,07	-10+70°C	TO-220 (КТ-28-2)
KP142ЕН18	LM337	N	1,2-37	1,5	Vi-Vo=40	1,5	0,07	-10+70°C	TO-220 (КТ-28-2)
142ЕН5А		P	5 ± 0,1	3	15	1	0,05	-60+125°C	4116.4-3
142ЕН5Б			6 ± 0,12	3					
142ЕН5В			5 ± 0,1	2					
142ЕН5Г			6 ± 0,12	2					
K142ЕН5А		P	5 ± 0,1	3	15	1	0,05	-45+85°C	4116.4-3
K142ЕН5Б			6 ± 0,12	3					
K142ЕН5В			5 ± 0,1	2					
K142ЕН5Г			6 ± 0,12	2					
KP142ЕН5А	7805С	P	5 ± 0,1	2	15	1,33	0,05	-45+70°C	TO-220 (КТ-28-2)
KP142ЕН5Б	7806С		6 ± 0,12			1,33			
KP42ЕН5В			5 ± 0,18			1			
KP142ЕН5Г			6 ± 0,21			1			
142ЕН8А		P	9 ± 0,27	1,5	35	0,67	0,05	-60+125°C	4116.4-3
142ЕН8Б			12 ± 0,36						
142ЕН8В			15 ± 0,45						
K142ЕН8А		P	9 ± 0,27	1,5	35	0,67	0,05	-45+85°C	4116.4-3
K142ЕН8Б			12 ± 0,36						
K142ЕН8В			15 ± 0,45						
KP142ЕН8А	7809С	P	9 ± 0,27	1,5	35	0,67	0,05	-45+70°C	TO-220 (КТ-28-2)
KP142ЕН8Б	7812С		12 ± 0,36	1,5	35	0,67	0,05		
KP142ЕН8В	7815С		15 ± 0,45	1,5	35	0,67	0,05		
KP142ЕН8Г			9 ± 0,36	1	30	1,5	0,1		
KP142ЕН8Д			12 ± 0,48	1	30	1,5	0,1		
KP142ЕН8Е			15 ± 0,6	1	30	1,5	0,1		
KP142ЕН8Ж			12,8	1,5	35	0,67	0,05		
KP142ЕН8И			12,8	1	30	1,5	0,1		
142ЕН9А		P	20 ± 0,4	1,5	40	0,67	0,05	-60+125°C	4116.4-3
142ЕН9Б			24 ± 0,48						
142ЕН9В			27 ± 0,54						
K142ЕН9А		P	20 ± 0,4	1,5	40	0,67	0,05	-45+85°C	4116.4-3
K142ЕН9Б			24 ± 0,48						
K142ЕН9В			27 ± 0,54						

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Интегральные схемы линейных стабилизаторов напряжения

Обозначение	Аналог	Полярность	Выходное напряжение, (В)	Выходной ток, (А)	Входное напряжение, (В)	Нестабильн. по току, (%/А)	Нестабильн. по напряжению, (%/В)	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
KP142ЕН9А	7820С	P	20 ± 0,4	1,5	35	0,67	0,05	-45+70°C	TO-220 (КТ-28-2)
KP142ЕН9Б	7824С		24 ± 0,48	1,5	35	0,67	0,05		
KP142ЕН9В	7827С		27 ± 0,54	1,5	35	0,67	0,05		
KP142ЕН9Г			20 ± 0,6	1,0	30	1,5	0,1		
KP142ЕН9Д			24 ± 0,72	1,0	30	1,5	0,1		
KP142ЕН9Е			27 ± 0,81	1,0	30	1,5	0,1		
KP142ЕН9Ж			20 ± 0,8	1,5	40	1,34	0,166		
KP142ЕН9И	7824С		24 ± 0,96	1,5	40	1,34	0,166		
1157ЕН5В		P	5 ± 2%	0,25	30	0,004	0,05	-60+125°C	TO-39 (КТ-2)
KP1157ЕН5А		P	5 ± 0,1	0,1	35	0,01	0,05	-10+70°C	TO-126 (КТ-27)
KP1157ЕН5Б			5 ± 0,2	0,1		0,01			
KP1157ЕН5В			5 ± 0,1	0,25		0,04			
KP1157ЕН5Г			5 ± 0,2	0,25		0,04			
KP1157ЕИ9А		P	9 ± 0,18	0,1	35	0,01	0,05	-10+70°C	TO-126 (КТ-27)
KP1157ЕН9Б			9 ± 0,36	0,1		0,01			
KP1157ЕН9В			9 ± 0,18	0,25		0,004			
KP1157ЕН9Г			9 ± 0,36	0,25		0,004			
KP1157ЕН12А		P	12 ± 0,24	0,1	35	0,01	0,05	-10+70°C	TO-126 (КТ-27)
KP1157ЕН12Б			12 ± 0,48	0,1		0,01			
KP1157ЕН12			12 ± 0,24	0,25		0,004			
KP1157ЕН12Г			12 ± 0,48	0,25		0,004			
KP1157ЕН18А		P	18 ± 0,36	0,1	40	0,01	0,05	-10+70°C	TO-126 (КТ-27)
KP1157ЕН18Б			18 ± 0,72	0,1		0,01			
KP1157ЕН18В			18 ± 0,36	0,25		0,004			
KP1157ЕН18Г			18 ± 0,72	0,25		0,004			
KP1157ЕН24А		P	24 ± 0,48	0,1	40	0,01	0,05	-10+70°C	TO-126 (КТ-27)
KP1157ЕН24Б			24 ± 0,96	0,1		0,01			
KP1157ЕН24В			24 ± 0,48	0,25		0,004			
KP1157ЕН24Г			24 ± 0,96	0,25		0,004			
KP1157ЕН501А	78L05	P	5 ± 0,1	0,1	25	0,00001	0,05	-10+70°C	TO-92 (КТ-26)
KP1157ЕН501Б			5 ± 0,8						
KP1157ЕН601А	78L06	P	6 ± 0,12	0,1	25	0,00001	0,05	-10+70°C	TO-92 (КТ-26)
KP1157ЕН601Б			6 ± 0,24						
KP1157ЕН801А	78L08	P	8 ± 0,16	0,1	25	0,00001	0,05	-10+70°C	TO-92 (КТ-26)
KP1157ЕН801Б			8 ± 0,32						
KP1157ЕН901А	78L09	P	9 ± 0,18	0,1	30	0,000001	0,05	-10+70°C	TO-92 (КТ-26)
KP1157ЕН901Б			9 ± 0,36						
KP1157ЕН1201А	78L12	P	12 ± 0,24	0,1	30	0,000001	0,05	-10+70°C	TO-92 (КТ-26)
KP1157ЕН1201Б			12 ± 0,48						
KP1157ЕН1501А	78L15	P	15 ± 0,3	0,1	35	0,000001	0,05	-10+70°C	TO-92 (КТ-26)
KP1157ЕН1501Б			15 ± 0,6						

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ



Интегральные схемы линейных стабилизаторов напряжения

Обозначение	Аналог	Полярность	Выходное напряжение, (В)	Выходной ток, (А)	Входное напряжение, (В)	Нестабильн. по току, (%/А)	Нестабильн. по напряжению, (%/В)	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
КР1157ЕН1801А КР1157ЕН1801Б	78L18	Р	18 ± 0,36 18 ± 0,72	0,1	35	0,000001	0,05	-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1157ЕН2401А КР1157ЕН2401Б	78L24	Р	24 ± 0,48 24 ± 0,96	0,1	40	0,000001	0,05	-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1157ЕН2701А КР1157ЕН2701Б	78L27	Р	27 ± 0,54 27 ± 1,08	0,1	40	0,000001	0,05	-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1162ЕН5А КР1162ЕН5Б	7905С	Н	-5 ± 0,1 -5 ± 0,2	1,5	35	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН6А КР1162ЕН6Б	7906С	Н	-6 ± 0,12 -6 ± 0,24	1,5	35	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН8А КР1162ЕН8Б	7908С	Н	-8 ± 0,16 -8 ± 0,32	1,5	35	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН9А КР1162ЕН9Б	7909С	Н	-9+/-0,18 -9+/-0,36	1,5	35	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН12А КР1162ЕН12Б	7912С	Н	-12 ± 0,24 -12 ± 0,48	1,5	40	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН15А КР1162ЕН15Б	7915С	Н	-15 ± 0,3 -15 ± 0,6	1,5	40	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН18А КР1162ЕН18Б	7918С	Н	-18 ± 0,36 -18 ± 0,72	1,5	40	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1162ЕН24А КР1162ЕН24Б	7924С	Н	-24 ± 0,48 -24 ± 0,96	1,5	40	1,3	0,11	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1168ЕН5А КР1168ЕН5Б	79L05	Н	5 ± 0,1 5 ± 0,2	0,1	25			-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1168ЕН6А КР1168ЕН6Б	79L06	Н	6 ± 0,12 6 ± 0,24	0,1	25			-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1168ЕН8А КР1168ЕН8Б	79L08	Н	8 ± 0,16 8 ± 0,32	0,1	25			-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1168ЕН9А КР1168ЕН9Б	79L09	Н	9 ± 0,18 9 ± 0,36	0,1	25			-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1168ЕН12А КР1168ЕН12Б	79L12	Н	12 ± 0,24 12 ± 0,48	0,1	30			-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
КР1168ЕН15А КР1168ЕН15Б	79L15	Н	15 ± 0,3 15 ± 0,6	0,1	30			-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)
К1156ЕР1П	TL432	Регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор с гарантируемой температурной стабильностью $U_{ref} = 1,24В ± 1%$, возможность втекающего тока 200 мА, низкий динамический выходной импеданс 0,2 Ом, низкий выходной шум, минимальный ток катода для регулирования 300 мкА, $U_{вых} = 1,24 ÷ 20В$ с помощью двух внешних резисторов.						-45+85°С	ТО-92 (КТ-26)
КР142ЕН19А,Б	TL431	Программируемые прецизионные источники опорного напряжения, $U_{вых}$ до 36В.						-10+70°С	ТО-92 (КТ-26)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
СХЕМЫ

Интегральные схемы линейных стабилизаторов с низким проходным напряжением

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
К1055ЕП2	без аналога	Трехканальный ЛСН с низким $U_{прох}$. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от КЗ, тепловая защита, внешняя блокировка каналов. $U_{вых} = 5-20В$, $I_n = 1А$, 100мА, 75мА.	-40+85°С	Мультиватт-15
К1055ЕП4	без аналога	Четырехканальный ЛСН с низким $U_{прох}$. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от КЗ, тепловая защита, внешняя блокировка каналов. $U_{вых}/I_n = 12В/500 мА$, 6В/50 мА, 5В/50 мА, 1,2В/50 мА.	-40+85°С	Мультиватт-15
К1156ЕН1	LM2925	ЛСН с низким $U_{прох}$. Внешняя установка задержки сигнала сброса, защита от переплюсовки, выбросов $U_{вх}$ до 60В, от КЗ, тепловая защита. $U_{вх max} = 40В$, $U_{вых} = 5В$, $I_n = 0,75А$, $U_{прох} = 0,6В$.	-45+85°С	ТО-220-5
К1156ЕН5В	LM2931Т	Регулируемый ЛСН с низким $U_{прох} = 0,6В$ при $I_n = 0,75А$, $U_{вх}$ до 40В, $U_{вых} = 1,5В ÷ 15В$.	-45+85°С	ТО-220-5
К1156ЕН6ПХ	CS5201-3	ЛСН с низким $U_{прох} = 1В$ при $I_n = 1А$, $U_{вых} = 1,5В ÷ 3,3В$ (ряд фиксированных напряжений), нестабильность $U_{вых} < ± 1,5%$.	-45+85°С	ТО-220 (КТ-28-2)
К1156ЕР2П	CS5201	Регулируемый ЛСН с низким $U_{прох} = 1В$ при $I_n = 1А$, $U_{вых} = (1,25В ÷ 5,5В) ± 1,5%$.	-45+85°С	ТО-220 (КТ-28-2)
КР1158ЕНХХА,Б	LM2930 LM2931А	Трехвыводной ЛСН с низким $U_{прох}$. Защита от переплюсовки, выбросов $U_{вх}$ до 60В, от КЗ, тепловая защита. На выходе ряд фиксированных напряжений в диапазоне $U_{вх max} = 26В$, $U_{вых} = 3 - 15В$, $I_n = 0,15А$, $U_{прох} = 0,4В$.	-10+70°С	ТО-251
КР1158ЕНХХВ,Г	LM2930 LM2931А	Трехвыводной ЛСН с низким $U_{прох}$. Защита от переплюсовки, выбросов $U_{вх}$ до 60В, от КЗ, тепловая защита. На выходе ряд фиксированных напряжений в диапазоне $U_{вх max} = 26В$, $U_{вых} = 3 - 15В$, $I_n = 0,5А$, $U_{прох} = 0,6В$.	-10+70°С	ТО-220 (КТ-28-2)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
СХЕМЫ



Интегральные схемы управления импульсными источниками питания

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
K1033EY15AP	UC3842	ИС управления одноканальными ИСН. Токовый ШИМ – режим. Us max= 30В, Is =1А, Fs max=500кГц, коэфф. заполнения –100%. Uвкл = 16В, Uвыкл = 10В.	-10+70°C	DIP-8
K1033EY15BP	UC3843	ИС управления одноканальными ИСН. Токовый ШИМ, полумостовой выход. Us max= 30В, Is=1А, Fs max=500кГц, коэфф. заполнения –100%. Uвкл = 8,5В, Uвыкл = 7,9В.	-10+70°C	DIP-8
K1033EY16AP	UC3844	ИС управления одноканальными ИСН. Токовый ШИМ – режим. Us max = 30В, Is=1А, Fs max=500кГц, коэфф. заполнения –50%. Uвкл = 16В, Uвыкл = 10В.	-10+70°C	DIP-8
K1033EY16BP	UC3845	ИС управления одноканальными ИСН. Токовый ШИМ – режим. Us max= 30В, Is=1А, Fs max=500кГц, коэфф. заполнения –50%. Uвкл = 8,5В, Uвыкл = 7,9В.	-10+70°C	DIP-8
KP1114EY4	TL494	ИС управления ИСН. Uпит = 8 – 40 В, Iвых = 200 мА, fком = 200 кГц.	-10+70°C	DIP-16 (2103.16-1)
K1155EY2	L296	ИС - мощная универсальная подсистема управления ИСН. Us = 5,1 ÷ 40В, Is = 4А, f = 200 кГц.	-60+85°C	Мультиватт-15
KP1156EY1	MA78S40	ИС - универсальная подсистема управления и регулирования импульсным источником питания. Us=3-40В, Is=1А, Fs=0,1-100кГц.	-10+85°C	DIP-16 (238.16-2)
K1156EY1	MA78S40	ИС - универсальная подсистема управления и регулирования импульсным источником питания. Us=3-40В, Is=1А, Fs=0,1-100кГц.	-10+70°C	4112.16-3,3Н (ТАКТ-256)
K1156EY2P	ИС3825	ИС управления двухтактным ИСН. Токовый (ШИМ-режим), прямая связь по Uвх, два полумостовых выхода, ШИМ-защелка, плавный запуск. Us=30В, Is=1,5А, Fs=1МГц, tзад =50нс.	-10+70°C	DIP-16 (238.16-1)
K1156EY2A			-60+125°C	4112.16-3,3Н
K1156EY2Б			-60+85°C	(ТАКТ-256)
K1156EY2В			-40+85°C	
K1156EY2Г			-10+85°C	
1156EY2			-60+85°C	4112.16-3
K1156EY3	UC3823	ИС управления одноканальным ИСН. Токовый (ШИМ-режим), прямая связь по Uвх, прямой и инверсный выход, ШИМ-защелка, плавный запуск. Us=30В, Is=1,5А, Fs=1МГц, tзад =50 нс.	-10+85°C	DIP-16 (238.16-1)
K1156EY3А			-60+125°C	4112.16-3,3Н
K1156EY3Б			-60+85°C	(ТАКТ-256)
K1156EY3В			-40+85°C	
K1156EY3Г			-10+85°C	
K1156EY5P	МС34063АР1	DC – DC конвертер. Внутренний температурно-компенсированный источник опорного напряжения, компаратор, генератор с управляемой от схемы ограничением по току скважностью, драйвер и мощный выходной ключ. Us=3-40В, Is=1,5А, Fs=0,1-100 кГц.	-10+70°C	DIP-8

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
СХЕМЫ

Интегральные схемы управления нагрузками

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
149КТ1А -1В		4-х канальный ключ переключения электрических сигналов. Us=1-23В. Is = 50мА.	-60+125°C	401.14-5М
522КН1А - Б 522КН2А - В	без аналога	Усилитель релейного типа для управления электромеханическим реле. Uком = 3В ÷ 60В, Uпит = 30В, Iком = 120мА.	-60+85°C	401.14 - 5М
571ХЛ1		Интерфейсная схема в составе 4-х двунаправленных магистральных элементов. Us=5 ± 10%, In=0,025А.	-60+125°C	4112.16-2,2Н
571ХЛ2		Интерфейсная схема в составе 6-ти магистральных элементов с тремя состояниями на выходе. Us=5 ± 10%, In =0,025А.	-60+125°C	4112.16-2,2Н
571ХЛ3		Интерфейсная схема со сдвоенным трехходовым многофункциональным элементом с тремя состояниями на выходе. Us=5 ± 10%, In =0,025А.	-60+125°C	4112.16-2,2Н
571ХЛ4 КР571ХЛ4		Интерфейсная схема в составе 6-ти магистральных инвертирующих элементов с тремя состояниями на выходе и на входе. Us=5 ± 10%, In =0,025А.	-10+70°C	4112.16-2,2Н 238.16-2 (DIP-16)
571ХЛ5 КР571ХЛ5		Интерфейсная схема в составе 6-ти магистральных неинвертирующих элементов с тремя состояниями на выходе и на входе. Us=5 ± 10%.	-10+70°C	4112.16-2,2Н 238.16-2 (DIP-16)
1109КТ5		Высоковольтный коммутатор тока для управления состоянием магнитных цепей. Us=4,5-5,5В. Напряжение коммутации 42 В, выходной ток Io =1-2А.	-60+85°C	4112.16-3,3Н (ТАКТ-256)
1109КТ7		Коммутатор тока для переключения нелинейных цепей на полупроводниковых элементах. Us=4,5-5,5В. Коммутируемое напряжение Us=45-55В. Коммутируемый ток Is=0,25А.	-60+85°C	4118.24-1,1Н
KP1109КТ10	ULN2004	Счетверенные ключи Дарлингтона. Iвх = 1,5А, Iвых = 50В, Uвх = 30В.	-10+70°C	DIP –16 (238.16-2)
1109КТ11		Четырехканальный коммутатор тока для переключения магнитных цепей. Usw=18-22В, Io =1-3А.	-60+125°C	4118.24-1,1Н
1109КТ13		Четырехканальный коммутатор тока со схемой контроля для управления нелинейными элементами. Usw=10,8-29,7В, Io =0,04А.	-60+85°C	4118.24-1Н
K1109КТ21 K1109КТ22 K1109КТ23 K1109КТ24	ULN2002А ULN2003А ULN2004А ULN2005А	7-ми канальный ключ Дарлингтона. Iвх = 0,35А; Uвх<=13В, Iвх<=1,2 мА; Uвх<=13В, Iвх<=1,2 мА; Uвх<=3В, Iвх<=1,3 мА; Uвх<=8В, Iвх<=3,5 мА;	-10+70°C	DIP –16 (238.16-2)
KP1128КТ3А	L293В	4-х канальный полумостовой коммутатор тока. Входная логика совмещена с ТТЛ - уровнями, 3-состояние на выходе. Управление двигателями шаговыми и постоянного тока. Us=4,5 - 36В, Is=1А.	-10+70°C	DIP-16 (238.16-2)
KP1128КТ4P	L293D	Us=4,5 - 36В, Is=0,6А.		
KP1233КТ2P		ИС электронного кодового ключа для систем контроля и управления доступом контактного типа. Применение: пластиковая карта, брелки, браслеты, электронный ключ с индивидуальным номером.	-10+70°C	ТО-92 (КТ-26)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
СХЕМЫ



Интегральные схемы, операционные усилители, компараторы, детекторы

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
K1401УД2	LM324	Маломощный счетверенный операционный усилитель U _{cc} =3-30В.	-10+70°C	DIP-14 (2102.14-1)
K1401СА1	LM339	Маломощный счетверенный компаратор U _{cc} =3-30В.	-10+70°C	DIP-14 (2102.14-1)
K1230СДПХХП	МС34064	Детектор понижения напряжения ниже допустимого уровня. ИС предназначена для использования в микропроцессорных системах для формирования сигнала Reset.	-45+85°C	ТО-92 (КТ-26)
K1230ДПХХ1П	без аналога	Детектор понижения напряжения ниже допустимого уровня. Отличие от микросхемы К1230ДПХХП - открытый коллектор выходного транзистора.	-45+85°C	ТО-92 (КТ-26)
K1407УД2Р	LM4250	Программируемый маломощный ОУ U _{пит} = ± 12В, K _у > 50000, U _{см} < 5 мВ, I _{вх} < 150 нА, I _{пот} < 100 мкА, f > 3 мГц, K _{ос ср} > 70 дБ.	-60+85°C	DIP-8
K1460УД2Р	ТСА0372	Сдвоенный мощный операционный усилитель. Выходной ток 1,0 А, скорость нарастания 1,3В/мкс.	-40+70°C	DIP-8
K1460УД2Р1			-45+125°C	Power DIP- (12+4)
K1464СА1Р	LM393	ИС сдвоенного микромощного компаратора напряжения. Диапазон напряжений источника питания: -однополярное питание 2 ÷ 36В; -двуполярное питание ± 1,0 ÷ ± 18В.	-40+85°C	DIP-8
K1464УД1Р	LM358	Микросхема сдвоенного микромощного операционного усилителя. Напряжение питания: -однополярное питание - 3 ÷ 32В; -двуполярное питание ± 1, ÷ ± 16В. Выходное напряжение согласуется со всеми типами логических схем.	-40+85°C	DIP-8

Интегральные схемы для телефонии

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
KP1059КН1		ИС переключения абонентской линии. Переключение, разъединение и контроль линии. Двухнаправленные тиристорные переключатели, логическая дешифрация, схема компенсации, защита по напряжению.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
KP1059КН2		ИС телефонного коммутатора телефонной линии для систем охранной сигнализации, предназначена для использования в телефонных устройствах вместо реле РПС-34.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
KP1059КП1		Автоматический телефонный коммутатор два абонента – один номер. Невозможность прослушивания с параллельного аппарата при наборе цифр.	-10+70°C	DIP-16 (2103.16-1)
KA2410	СВ31001Р СВ31002Р	ИС формирование тонального звонка. U _{cc} =36В, P=0,45Вт, F1=512Гц, F2=640Гц, F3=10Гц.	-10+70°C	DIP-8

Высоковольтные интегральные схемы для устройств отображения информации

Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
K1109КН1А	без аналога	Высоковольтный коммутатор напряжения для записи и стирания информации на газоразрядных индикаторных панелях переменного тока: - коммутируемое напряжение U _s =30 ÷ 140 В; - коммутируемый ток I _s = ± 2 мА; - коммутируемое напряжение U _s =30 ÷ 200 В.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
K1109КН1Б				
K1109КН2		8-ми разрядный коммутатор анодного напряжения управления вакуумными люминесцентными индикаторами: - коммутируемое напряжение U _s = 80 В; - коммутируемый ток I _s = 0,01А.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
1109КН4	без аналога	4-х разрядный коммутатор напряжения селективной записи и стирания информации на индикаторных панелях: - коммутируемое напряжение U _s = 20 ÷ 220 В; - коммутируемый ток I _s = 0,1А; - коммутируемое напряжение U _s = 20 ÷ 160 В; - коммутируемое напряжение U _s = 20 ÷ 220 В.	-60+85°C	4112.16-1,2,2H
K1109КН4А			-10+70°C	DIP-16 DIP-16
K1109КН4Б				
1109КН5		Коммутатор напряжения для управления газоразрядными индикаторами: - коммутируемое напряжение U _s = 20 ÷ 220 В.	-60+85°C	4112.16-1,2,2H
KP1109КН14А÷Г	TD62781А NE594N UDN6118А-2	8-ми разрядный коммутатор анодного напряжения для управления вакуумными люминесцентными индикаторами: - коммутируемое напряжение U _s = 90 В для А, В, U _s = 70 В для Б, Г; - коммутируемый ток I _s = 30 мА; - встроенные резисторы, подключаемые к выходам ключей R = 125 кОм для А и Б.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
KP1109КН15	без аналога	Шестиразрядный драйвер цветных вакуумных индикаторов. Содержит 6-ти разрядный сдвиговый регистр: - коммутируемое напряжение U _s = +5 ÷ - 100В; - коммутируемый ток I _s = 0,5мА.	-10+70°C	DIP-16 (238.16-2)
K1109КТ1А	без аналога	Коммутатор тока управление индикаторных панелей постоянного тока сегментного типа: - коммутируемое напряжение U _s =150В; - коммутируемый ток I _s =0,85 ÷ 1,15А; - коммутируемое напряжение U _s =205В.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
K1109КТ1Б				
1109КТ4А	без аналога	Коммутатор с программируемым уровнем выходного тока: - коммутируемое напряжение U _s = ± 210 В; - коммутируемый ток I _s = 0,1А; - коммутируемый ток I _s = 0,2А.	-60+85°C -10+70°C	DIP-18 4112.16-1,2,2H 2104.18-4
K1109КТ4Б			-60+85°C -10+70°C	DIP-18 4112.16-1,2,2H 2104.18-4
K1109КТ4БМ				
K1109КТ4А	без аналога	Коммутатор тока управление газоразрядными матричными знаковсинтезирующими индикаторными панелями: - коммутируемое напряжение U _s = ± 210 В; - коммутируемый ток I _s = 0,1А; - коммутируемый ток I _s = 0,2А.	-10+70°C	DIP-18 (2104.18-4)
K1109КТ4Б				
K1224ПН1Р	SP4424	Преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное. Содержит два внутренних автогенератора. U _{пит} = 2,2 ÷ 3,6В, U _{вых} > 120 В, С _{нагр} = 55 пФ.	-10+70°C	DIP-8
K1224ПН3Р	SP4412А	Преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное с внешним автогенератором. Содержит два внутренних автогенератора. U _{пит} = 2,2 ÷ 3,6В, U _{вых} > 120В, С _{нагр} = 2 пФ.	-10+70°C	DIP-8

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ



Интегральные схемы для управления сетевым напряжением

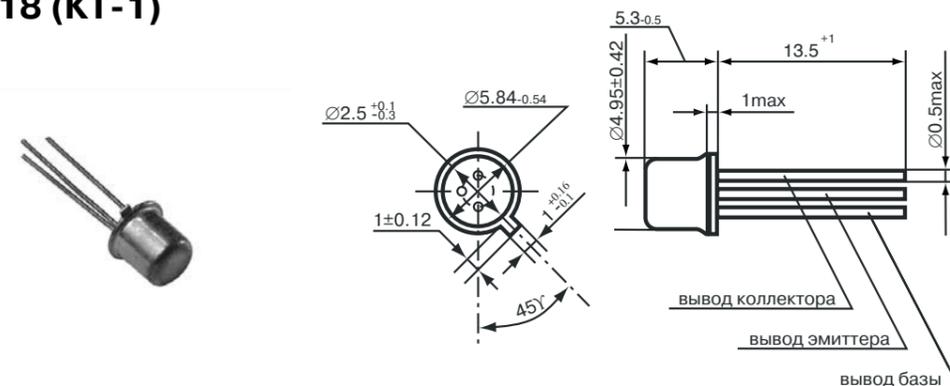
Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
KP1182PM1P	без аналога	Контроллер напряжения сетевого питания. Плавное вкл /выкл и управление мощностью для ламп накаливания, электродвигателем. $U=400В$, $U_{ост} = 1,3В$. $P_{нагр} = 150Вт$.	-40+70°C	Power Dip (12+4)
KP1182CA1	без аналога	Двухфазный контроллер сетевого питания. Автоматическое прерывание сетевого питания для защиты от поражения электротоком. $U=400В$, $t_{сраб} = 10мс$, $d_{сраб} = 5mA$, $I_{упр} = 300 mA$.	-40+70°C	DIP-16 (2103.16-1)
KP1182ГГ2	без аналога	Полумостовой высоковольтный автогенератор. Электронное пускорегулирующее устройство люминесцентных ламп. $U_{i max} = 400В$, $I_{o max} = 0,6A$.	-40+85°C	DIP-16 (2103.16-1)
KP1182ГГ3	без аналога	Полумостовой высоковольтный автогенератор для применения в сети переменного тока до 240В. ИС преобразует постоянное напряжение в высокочастотное напряжение 30-50 Гц для гальванически развязанных вторичных источников питания мощностью до 20 Вт и галогенных ламп.	-40+70°C	DIP-8
KP1182КП1	K1100E70	Диодный симистор с фиксированным напряжением открывания. Применение – коммутация тока через нити подогрева электролюминесцентных ламп до момента зажигания лампы. $U_T = 10 \div 105 В$, $I_{max} = 1 А$.	-10+70°C	ТО-92 (КТ-26)
KP1182КП2	без аналога	ИС фазового регулятора для коммутации тока через нити подогрева электролюминесцентных ламп до момента зажигания лампы. $I_{max} = 1 А$. Фазовый угол открывания определяется номиналом внешней емкости и коммутируемым напряжением, открывание регулятора при перегрузке по напряжению – не менее 450 В.	-10+70°C	ТО-126 (КТ-27)
KP1182КП4П	без аналога	Диодный симистор с фиксированным напряжением открывания. Применение – коммутация тока через нити подогрева электролюминесцентных ламп до момента зажигания лампы. $U_T = 160 \div 180 В$, $I_{max} = 1 А$.	-10+70°C	ТО-92 (КТ-26)

ДТЛ серия 112

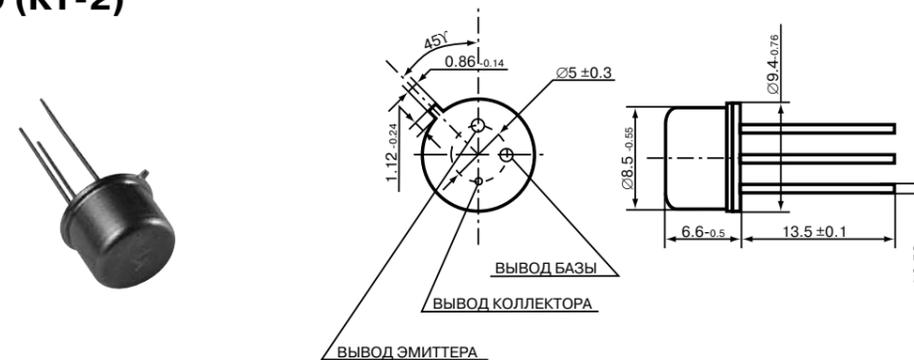
Обозначение	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
112ЛД1	без аналога	3 расширителя по ИЛИ.	-40+60°C	401.14-5М
112ТМ1	без аналога	2 Д-триггера с логикой на входе.	-40+60°C	401.14-5М

Корпуса

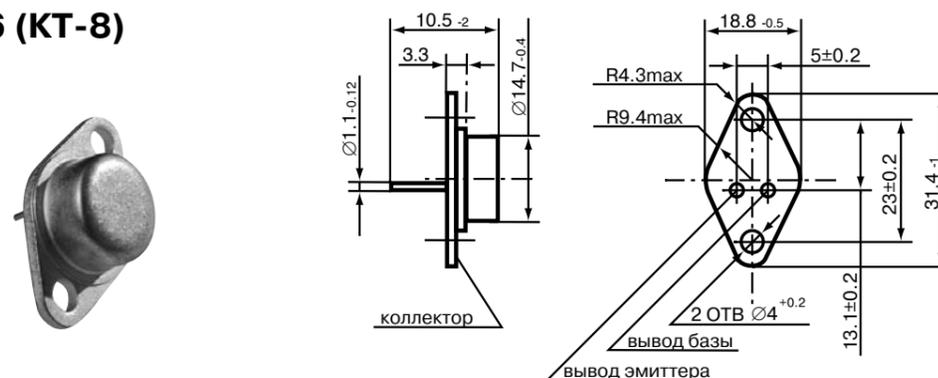
ТО-18 (КТ-1)



ТО-39 (КТ-2)

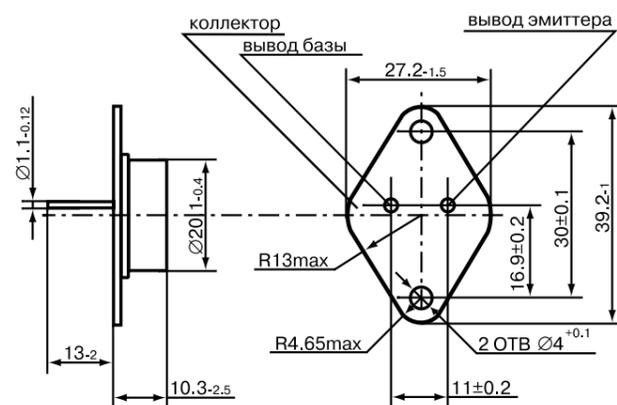


ТО-66 (КТ-8)

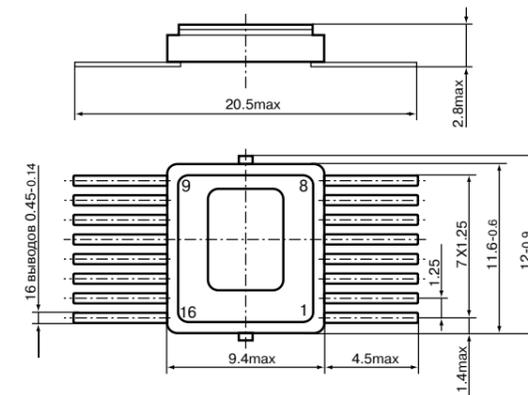
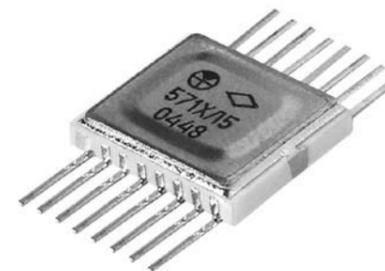




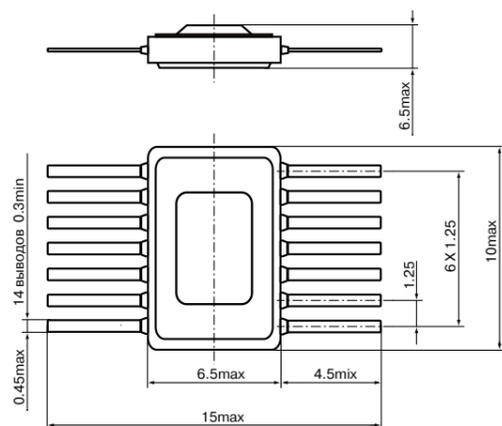
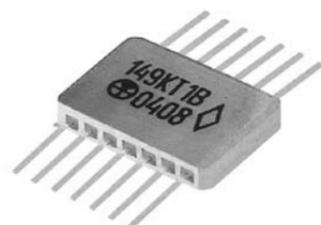
ТО-3 (КТ-9)



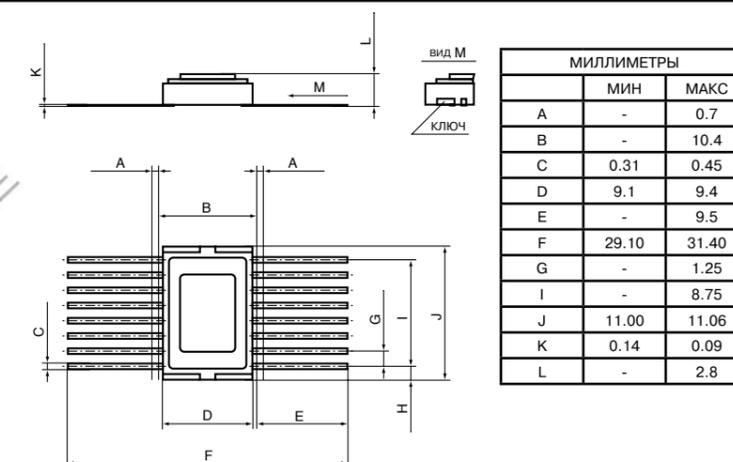
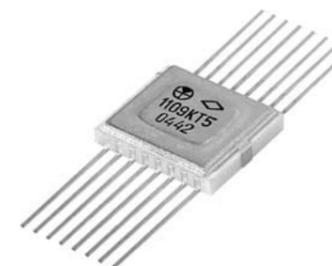
4112.16-2



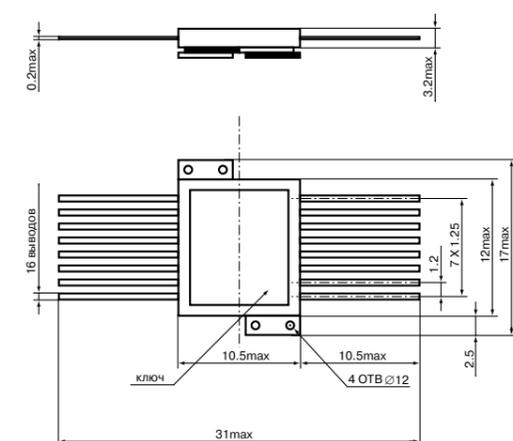
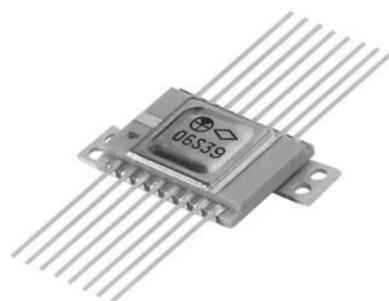
401.14-5M



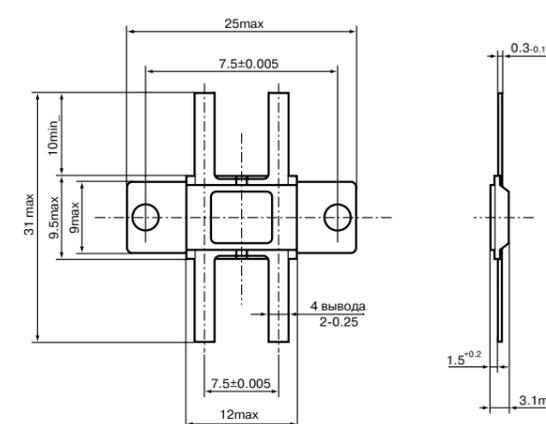
4112.16-3



402.16-7



4116.4-2

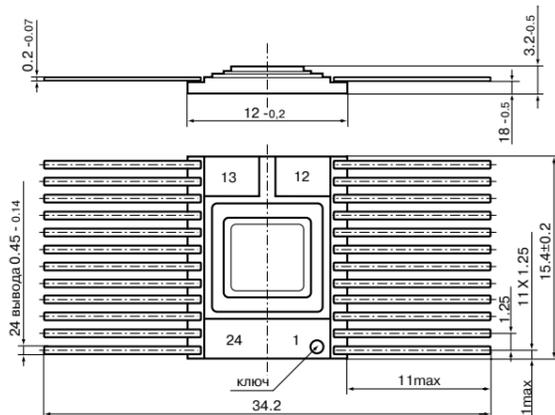
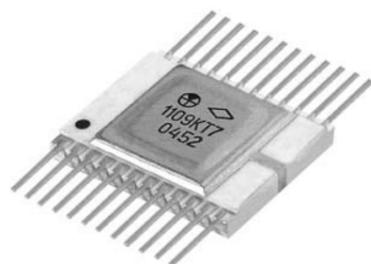


КОРПУСА

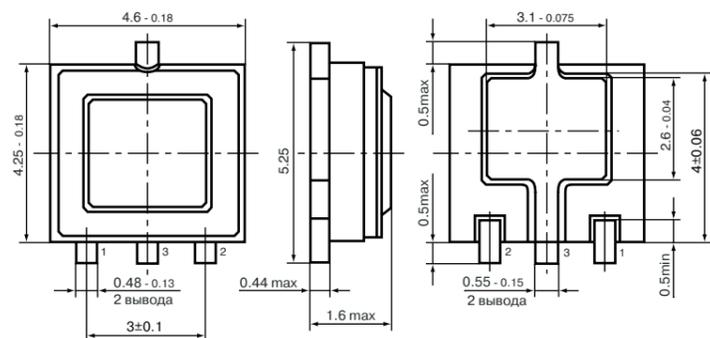
КОРПУСА



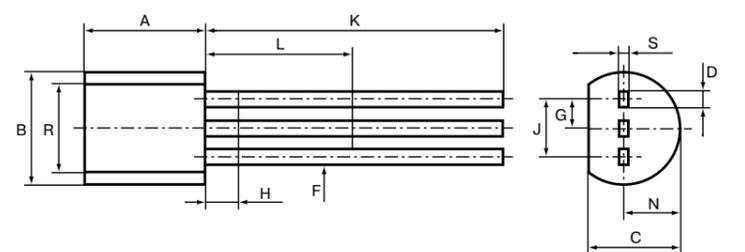
4118.24-1



5114Ю.4-2

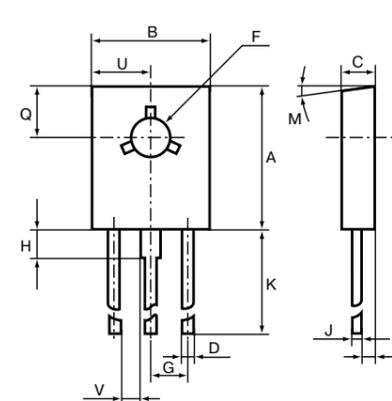


TO-92 (КТ-26)



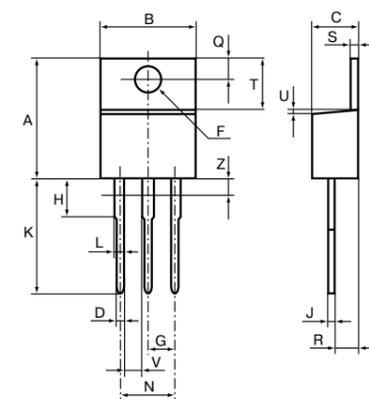
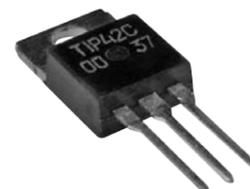
МИЛЛИМЕТРЫ		A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	N	R	S
МИН		4.32	4.45	3.18	0.37	0.41	1.15	-	2.42	12.70	-	2.04	3.43	0.39
МАКС		5.33	5.20	4.19	0.55	0.55	1.39	2.54	2.66	-	-	2.66	-	0.50

TO-126 (КТ-27)



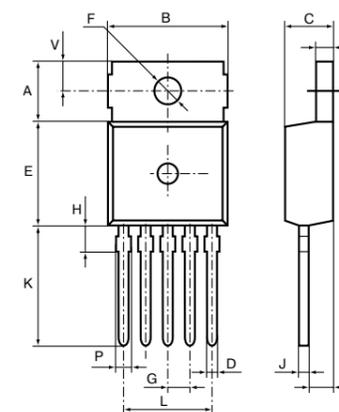
МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	10.80	11.04
B	7.50	7.74
C	2.42	2.66
D	0.70	0.8
F	2.93	3.30
G	2.39BSC	
H	1.27	2.41
J	0.39	0.63
K	14.61	16.63
M	3° TYP	
Q	3.76	4.01
R	1.15	1.39
U	3.69	3.93
V	1.02	-

TO-220 (КТ-28)



МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	14.48	15.75
B	9.66	10.28
C	4.07	4.82
D	0.64	0.88
F	3.61	3.73
G	2.42	2.66
H	2.80	3.93
J	0.46	0.55
K	12.70	14.27
L	1.15	1.52
N	4.83	5.33
Q	2.54	3.04
R	2.04	2.79
S	1.15	1.39
T	5.97	6.47
U	0.00	1.27
V	1.15	-
Z	-	2.04

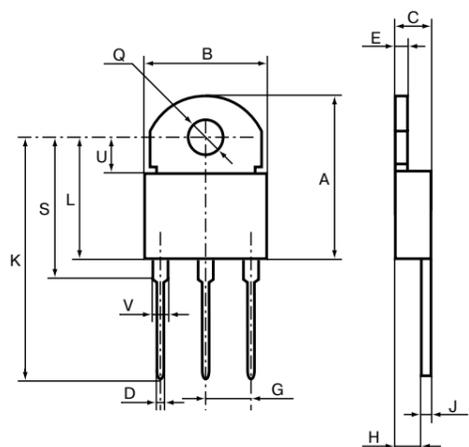
TO-220-5



МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	6.00	6.40
B	10.10	10.40
C	4.40	4.60
D	0.925	0.93
E	9.00	9.30
F	3.61	3.73
G	1.58	1.82
H	-	2.50
J	0.54	0.55
K	13.00	13.80
L	6.68	6.92
Q	2.60	2.80
P	-	1.00
R	2.50	2.70
S	1.10	1.35

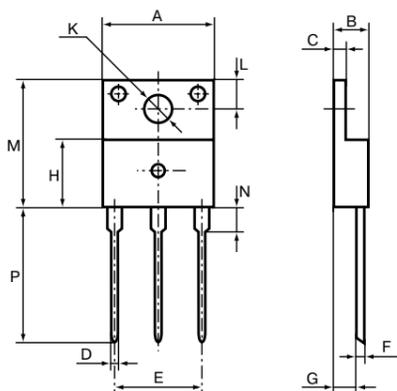


TO-218 (КТ-43)



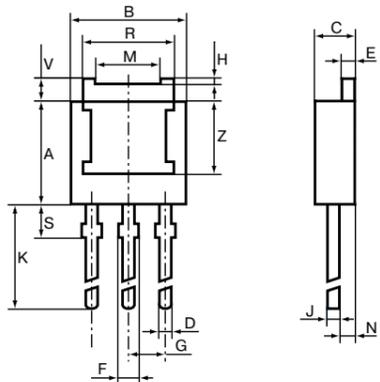
МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	19.30	19.80
B	14.80	15.70
C	4.20	4.70
D	1.00	2.00
E	1.85	2.00
G	5.21	5.72
H	2.60	3.00
J	0.40	0.60
K	31.90	33.60
L	14.70	15.30
Q	4.00	4.25
R	18.30	19.00
U	3.40	3.80
V	1.50	2.00

Isowatt-218 (КТ-43А)



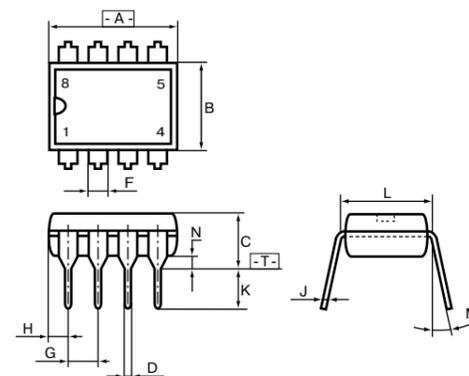
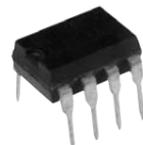
МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	15.60	16.00
B	5.20	5.60
C	3.40	3.80
D	1.00	1.20
E	10.80	11.20
F	0.40	0.50
G	3.05	3.45
H	11.10	11.50
L	5.30	5.50
M	3.20	3.60
N	21.20	21.60
P	16.50	17.50
R	-	3.00

TO-251



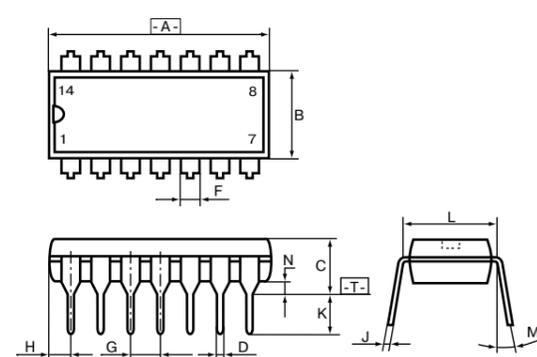
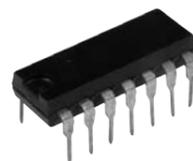
МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	5.97	6.22
B	6.35	6.73
C	2.19	2.38
D	0.64	0.88
E	0.46	0.58
F	0.76	1.14
G	2.28	
H	0.30	0.50
J	0.46	0.58
K	8.95	9.65
M	3.30	3.50
N	0.90	1.10
R	5.21	5.46
S	1.91	2.28
V	0.88	1.27
Z	4.32	-

Dip-8



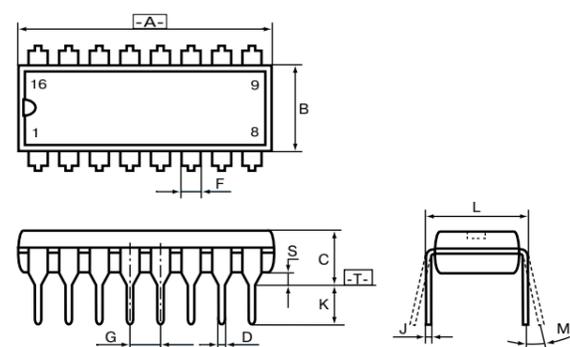
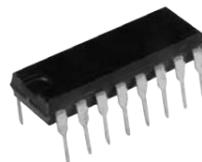
МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	9.60	10.00
B	6.20	6.60
C	4.05	4.45
D	0.38	0.51
F	1.05	1.50
G	2.5 BSC	
H	0.76	1.24
J	0.20	0.30
K	3.00	3.40
L	7.62 BSC	
M	0°	10°
N	0.80	1.00

Dip-14 (2102.14-1)



МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	18.16	19.56
B	6.10	6.60
C	-	5.00
D	0.38	0.53
F	1.02	1.78
G	2.54 BSC	
H	1.32	2.41
J	0.20	0.38
K	3.26	3.74
L	7.62 BSC	
M	0°	15°
N	-	1.70

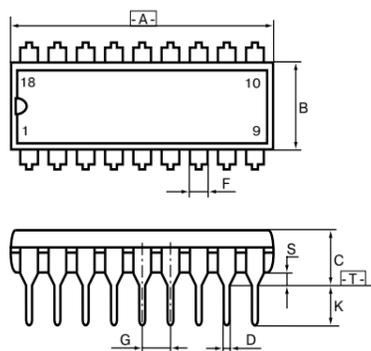
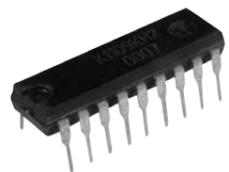
Dip-16 (2103.16-1) (238.16-2)



МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	20.16	21.00
B	6.42	7.00
C	-	5.00
D	0.41	0.55
F	-	1.50
G	2.5 BSC	
J	0.24	0.34
K	3.26	3.74
L	8.00	8.30
M	5°	15°
S	0.51	-

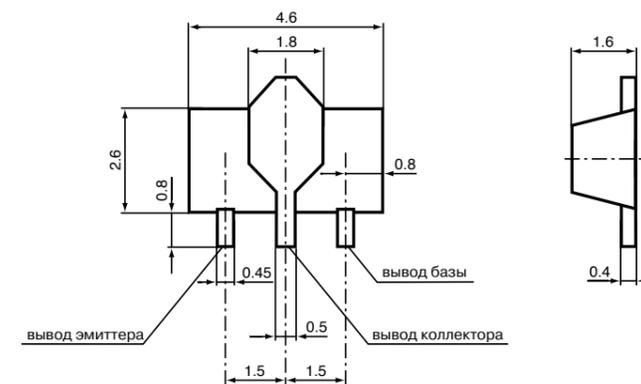
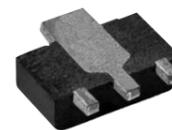


Dip-18 (2104.18-4)

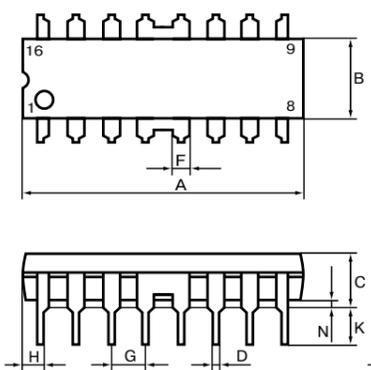


МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	22.16	23.00
B	6.42	7.00
C	-	5.00
D	0.41	0.55
F	-	1.50
G	2.54 BSC	
J	0.24	0.34
K	3.26	3.74
L	-	8.30
M	5°	15°
S	0.51	-

SOT-89 (КТ-47)

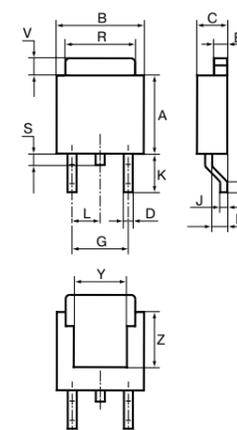


Power Dip (12+4)



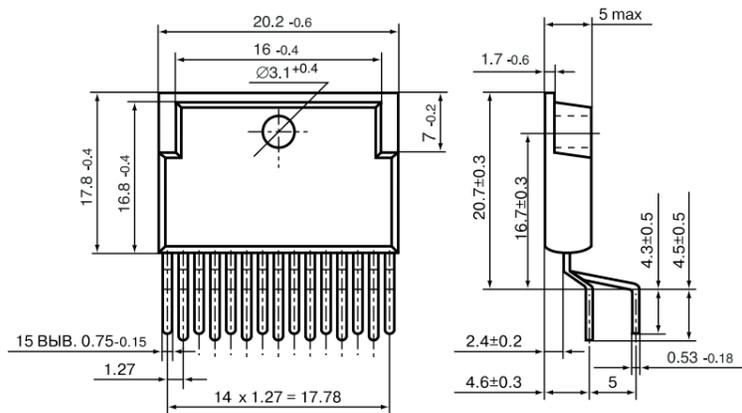
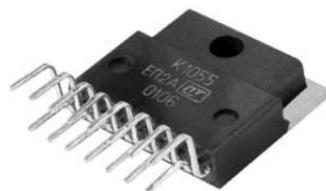
МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	18.80	21.34
B	6.10	6.60
C	4.06	5.08
D	0.38	0.53
F	1.02	1.78
G	2.54 BSC	
H	0.38	2.41
J	0.20	0.38
K	2.92	3.43
L	7.62 BSC	
M	0°	10°
N	0.51	1.02

TO-252

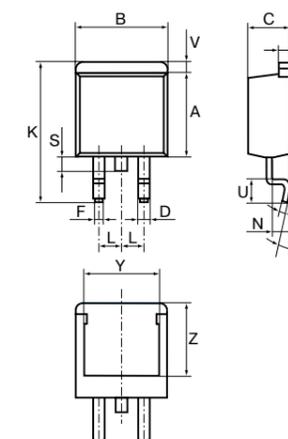


МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	5.97	6.22
B	6.35	6.73
C	2.19	2.38
D	0.64	0.88
E	0.46	0.58
F	0.76	1.14
G	4.57	
H	0.90	1.10
J	0.46	0.58
K	2.59	2.89
L	2.28	
R	5.21	5.46
S	0.64	1.02
V	0.88	1.27
Y	3.30	3.50
Z	4.32	-

Мультиватт-15



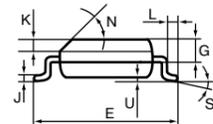
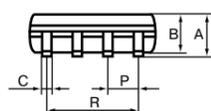
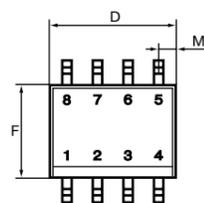
TO-263



МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	8.64	9.65
B	9.65	10.29
C	4.06	4.83
D	0.51	0.99
E	1.14	1.40
F	1.14	1.40
J	0.46	0.74
K	14.61	15.88
L	2.54	
M	0°	8°
N	2.03	2.79
S	1.27	1.78
U	2.29	2.79
V	1.02	1.40
Y	6.86	8.13
Z	7.11	8.13

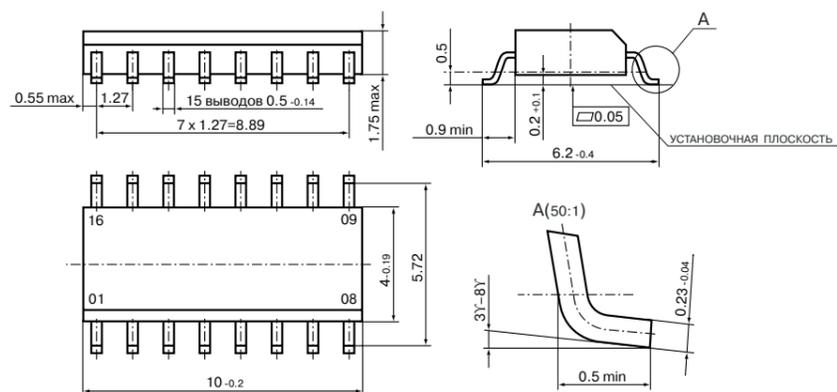


SO-8

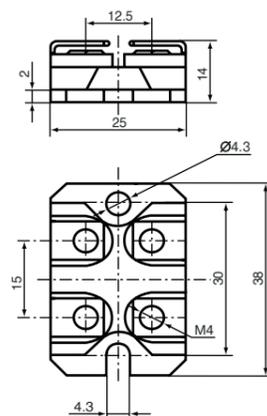


МИЛЛИМЕТРЫ		
	МИН	МАКС
A	1.35	1.75
B	1.25	1.55
C	0.36	0.48
D	4.80	5.00
H	5.80	6.20
E	5.80	6.20
F	3.8	4.0
G	0.65	0.85
J	0.19	0.25
K	0.25	0.50
L	0.28	0.48
M	0.60	0.60
N		45°
P	1.27	1.27
R	3.81	3.81
S	0°	8°
U	0.10	0.25

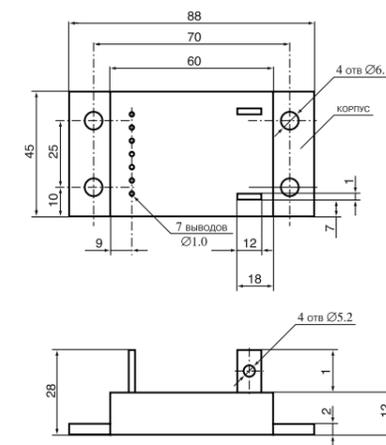
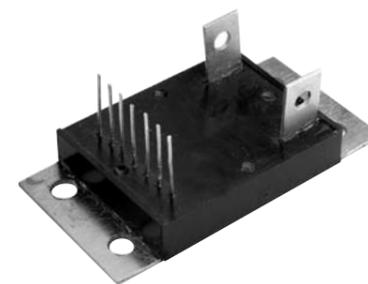
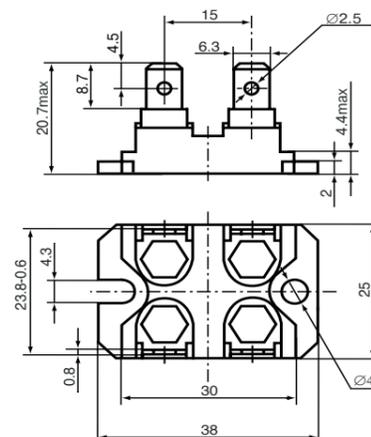
SO-16



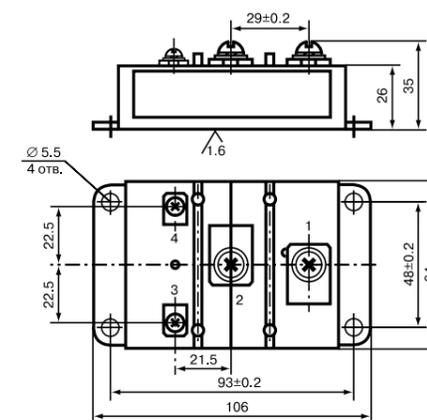
SOT-227 исполнение 1



SOT-227 исполнение 2



Чертеж 1



Чертеж 2